

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
К ЖУРНАЛУ «ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ»

Том 24, 1990 год

- А бакарова Н. С., см. Степуренко А. А. 4, 678
- А ббасов Ш. М., см. Бахышов А. Э. 7, 1318
- А бдукадыров А. Г., Барановский С. Д., Ивченко Е. Л. Низкотемпературные фотолюминесценция и фотопроводимость в нелегированных аморфных полупроводниках. 1, 136
- А бдукадыров А. Г., Ивченко Е. Л. Влияние ИК подсветки на проводимость фотоносителей в нелегированном аморфном полупроводнике. 5, 844
- А бдуллаев Х. О., Корольков В. И., Павловский М. В., Руссу Е. В., Табаров Т. С. Исследования планарных фотоспротивлений на основе InGaAs/InP со скрытым p^+ -затвором. 11, 1969
- А бдуллин Х. А., Мукашев Б. Н., Тамендаров М. Ф., Ташенов Т. Б., Чихрай Е. В. Исследование радиационных дефектов в p -Si методом нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней.* 2, 391
- А блова М. С., Кулпков Г. С., Першеев С. К., Ходжаев К. Х. Диффузионное легирование пленок α -Si : H примесями Sn, Ag, Te и его влияние на электрические свойства. 11, 1943
- А брамян Ю. А., Папазян К. З., Стафеев В. И. Вольт-амперные характеристики тонких пленок $Pb_{1-x}Sn_xTe$ (In) при различных уровнях фоновых засветок. 10, 1752
- А в акаян Л. П., Александрович С. В., Велюлин Э. И., Ефимов А. Д., Холина Э. Н., Чапнин В. А. Определение концентрации марганца в твердых растворах $Hg_{1-x}Mn_xTe$ методом электроотражения. 1, 193
- А веркиев Н. С., Гуткин А. А., Максимова О. Г., Осипов Е. Б. Влияние центров Mn_{Ga} в GaAs на эффект Фарадея вблизи края основной полосы поглощения. 9, 1632
- А ветисян С. К., Данагулян С. С., Минасян Г. Р. Деформация лазерного импульса, распространяющегося в n -Ge при гелиевых температурах. 8, 1421
- А ветисян С. К., Минасян Г. Р., Энфиаджян Р. Л. Нелинейное поглощение инфракрасного излучения в n -Ge при низких температурах. 4, 766
- А гранов Г. А., Иванов В. Г., Новоселов С. К., Трояновский В. С., Фантиков О. И. Влияние периодического импульсного электрического поля на фотоэлектрические свойства примесных компрессируемых полупроводников. 3, 438
- А гринская Н. В., Шапкова В. В. Метастабильные центры в низкоомных кристаллах CdTe:Cl n -типа. 4, 697
- А дамашвили Г. Т., Утуравли Г. Г., Пейкришвили М. Д. Акустические бризеры в ограниченных полупроводниках. 10, 1878
- А дамия Э. А., см. Аладашвили Д. И. 2, 234
- А дилов К. А., Турсунов Ш. С. Фотохимическая перестройка глубоких центров в кремнии, легированном селеном. 9, 1624
- А дилов М. К., см. Хакимов З. М. 1, 29
- А зоу С. А., Кульбачинский В. А., Миронова Г. А., Скипидаров С. Я. Локальные состояния в $In_xBi_{2-x}Te_3$. 2, 283
- А кимов А. В., Жпляев Ю. В., Криволапчук В. В., Шофман В. Г. Перезахват неосновных носителей в условиях фотоионизации в эпитаксиальном n -GaAs. 1, 82
- А кимченко И. П., Дымова Н. Н., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. Полоса фотолюминесценции 1.44 эВ в GaAs, имплантированном азотом и кремнием. 10, 1857
- А копян А. А., Болгов С. С., Савченко А. П., Салюк О. Ю. Магнитоцентриционный эффект в неоднородно легированных полупроводниках. 10, 1875
- А копян А. А., Витусевич С. А., М'алютенко В. К. Пространственное распределение носителей заряда в условиях контактной эксклюзии. 8, 1424
- А ксенов В. Ю., см. Андреев В. М. 10, 1757
- А кулович Н. И., Быковский В. А., Петренко В. В., Карпо-

* Статьи, отмеченные звездочкой, депонированы в ЦНИИ «Электроника».

- вич Л. М., Утенко В. П. Электrofизические свойства и фотолюминесценция кремния, легированного алюминием методом фотоядерных реакций. 3, 472
- Аладашвили Д. И., Адамия З. А., Лавдовский К. Г., Левин Е. И., Шкловский Б. И. Неомическая прыжковая проводимость слабокомпенсированных полупроводников. 2, 234
- Алекперов С. А., Алиев Ф. Л. Температурная зависимость шума $1/f$ в p -InSb. 5, 921
- Александров П. А., Баранова Е. К., Бударагин В. В., Демаков К. Д., Котов Е. В., Новиков А. П., Шемардов С. Г. Высокотемпературная ионная имплантация мышьяка в кремний. 6, 1132
- Александрович С. В., см. Авакянц Л. П. 1, 193
- Алексеева Г. Т., Вейс А. Н., Гурьева Е. А., Жукова Т. Б., Прокофьева Л. В. Примесные состояния индия в PbS. 12, 2155
- Алешкин В. Д., см. Кольцов Г. И. 5, 782
- Алешкин В. Я., Аншон А. В., Бабушкина Т. С., Батукова Л. М., Демидов Е. В., Звонков Б. Н., Малкина И. Г. Фотолюминесценция квантовых слоев $In_xGa_{1-x}As$, выращенных на плоскостях (100) и (111) арсенида галлия. 5, 892
- Алешкин В. Я., Романов Ю. А. Инверсные распределения электронов в полупроводниковых гетероструктурах с одной квантовой ямой. 1, 131
- Алешкин В. Я., см. Карнович И. А. 12, 2172
- Алиев К. М., см. Степуренко А. А. 4, 678
- Алиев М. И., см. Араслы Д. Г. 2, 365
- Алиев Ф. Л., см. Алекперов С. А. 5, 921
- Алтухов И. В., Покровский Я. Е., Смирнова О. И., Синис В. П. Бесконтактный СВЧ метод исследования кинетики примесной фотопроводимости в кремнии. 6, 1134
- Алфёров Ж. И., Журавлева В. В., Иванов С. В., Копьев П. С., Корольков В. И., Леденцов Н. Н., Мельцер Б. Я., Табаров Т. С. Электрические и оптические эффекты при резонансном туннелировании в $(Al, Ga)As$ - $GaAs$ -гетероструктурах с двойным барьером. 2, 361
- Алфёров Ж. И., Иванов С. В., Копьев П. С., Леденцов Н. Н., Луценко М. Э., Мельцер Б. Я., Неменов М. И., Устинов В. М., Шапошников С. В. Растекание и поверхностная рекомбинация неравновесных носителей в квантово-размерных $(Al, Ga)As$ ДГС РО лазерах с широким полоском. 1, 152
- Алфёров Ж. И., Иванов С. В., Копьев П. С., Леденцов Н. Н., Мельцер Б. Я., Луценко М. Э. $(Al, Ga)As$ ДГС РО лазеры на длины волн 0.8 мкм ($175 A/cm^2$) и 0.73 мкм ($350 A/cm^2$) с легированной квантовой ямой. 1, 201
- Алфёров Ж. И., Иванов С. В., Копьев П. С., Леденцов Н. Н., Мельцер Б. Я., Шапошников С. В. $(In, Ga, Al)As$ ДГС РО лазеры на длину волны 1.1 мкм с $(In, Ga)As$ напряженной квантовой ямой, ограниченной короткоперпной сверхрешеткой. 2, 359
- Алперович В. Л., Лубышев Д. И., Мигаль В. П., Семягин Б. Р., Ярошевич А. С. Спектры фототока β -легированных $GaAs$ сверхрешеток *in situ*. 3, 451
- Амброс В. П., Бурдиян И. И., Георгицз Е. И., Постолак И. Т., Погорельский В. М. Особенности излучательной рекомбинации полупроводниковых твердых растворов на основе $(GaSb)_x(HgTe)_{1-x}$, $(AlSb)_x(HgTe)_{1-x}$. 8, 1375
- Аммерлаан С. А. Дж., см. Ежевский А. А. 8, 1354
- Андаспаева А. А., Баранов А. Н., Гусейнов А. А., Именков А. Н., Колчанова Н. М., Яковлев Ю. П. Природа спонтанной электролюминесценции в гетероструктурах на основе $GaInAs$ для спектрального диапазона 1.8—2.4 мкм. 10, 1708
- Андреев А. П., Виолин Э. Е., Левин В. И., Таиров Ю. М., Цветков В. Ф., Яременко И. Е. Влияние отклонения от стехиометрии на свойства диффузионных p - n -переходов на основе карбида кремния. 5, 821
- Андреев В. М., Аксенов В. Ю., Казанцев А. Б., Прудких Т. А., Румянцев В. Д., Танклевская Е. М., Хвостиков В. П. Низкопороговые квантово-размерные $AlGaAs$ -гетеролазеры для диапазона длин волн 730—850 нм, полученные методом низкотемпературной ЖФЭ. 10, 1757
- Андреев В. М., Афанасьева Н. П., Еремин В. К., Строкач Н. Б., Тархин Д. В. Компенсация кремния при дрейфе лития из ограниченного резервуара. 3, 585
- Андреев В. М., Васильев А. М., Зимогорова Н. С., Лантратов В. М., Мырзин В. И. Фотолюминесцентные свойства $GaAs$, легированного реннем. 7, 1194
- Андреева В. Д., Анисимов М. И., Джумахамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г. Структура кристаллов $GaAs<Te>$, модифицированных импульсным лазерным излучением. 6, 1010
- Андреевский К. Н., Трахброт Б. М. Корреляция в поведении кислородных термодоноров и комплексов, ответственных за поглощение при 890 cm^{-1} , в Si, облученном в реакторе при разных температурах. 12, 2136
- Аникин М. М., Кузнецов Н. И., Лебедев А. А., Стрельчук А. М., Сыркин А. Л. Связь желтой электролюминесценции в $6H-SiC$ с глубокими центрами. 8, 1384
- Анисимов М. И., см. Андреева В. Д. 6, 1010
- Аниченко Н. М., см. Фомин И. А. 2, 231

- Антоненко Р. С., см. Емцев В. В. 2, 374
- Антонова И. В., Шаймеев С. С. Влияние легирующей примеси на процесс формирования разупорядоченной области в нейтронно-облученном кремнии. 7, 1240
- Антохин А. Ю., Козлов В. А. О связи шумовых характеристик с эффективностью термоэлектрического преобразования. 8, 1480
- Антошук В. В., см. Велиюлин Э. И. 11, 2060
- Аншон А. В., см. Аleshкин В. Я. 5, 892
- Аншон А. В., см. Карпович И. А. 12, 2172
- Арапов Ю. Г., см. Аронзон Б. А. 4, 687
- Араслы Д. Г., Рагимов Р. Н., Алиев М. И. Особенности распада фононов в твердом растворе $Ga_{1-x}In_xAs$. 2, 365
- Арлаускас К., см. Голикова О. А. 7, 1190
- Аронзон Б. А., Арапов Ю. Г., Зверева М. Л., Никитин М. С., Цидильковский И. М., Чумаков Н. К. Проводимость $n-Hg_{1-x}Cd_xTe$ в магнитных полях, превышающих поле перехода металл—диэлектрик. 4, 687
- Артамонов В. В., Валах М. Я., Нечипорук Б. Д., Романюк Б. Н., Стрельчук В. В. Исследование эффекта понно-пучкового отжига аморфизированных имплантацией приповерхностных слоев Si по спектрам КРС. 10, 1747
- Арутюнов Н. Ю., Соболев Н. А., Трашakov В. Ю., Шек Е. И. Образование позитронно-чувствительных дефектов в процессе термообработки кремния в хлорсодержащей атмосфере. 10, 1875
- Арутюнян В. М., Маргарян А. Л., Меликсетян В. А. Влияние полевой диссоциации экситонов на фототок в полупроводниках. 1, 203
- Арушанов Э. К., Лисунов К. Г., Рознован Ю. В., Шубников М. Л. Электрические свойства антимоноида кадмия, легированного Sm и Eu при низких температурах. 7, 1179
- Архипов В. И., Никитенко В. Р. О влиянии туннельной рекомбинации на квантовый выход фотогенерации носителей в неупорядоченных материалах. 11, 1923
- Архипов В. И., Никитенко В. Р. Стимулированная полем диффузия в некристаллических полупроводниках в случае переменного поля. 11, 2043
- Архипов В. И., Храмченков Д. В. Релаксационные процессы в структурах металл—аморфный полупроводник—металл. 9, 1618
- Аскеров Б. М., Кулиев Б. И., Панахов М. М., Райх М. Э. Подвижность электронов и термоэдс полупроводниковой сверхрешетки при рассеянии на фононах. 12, 2241
- Асриян Л. В., Петросян С. Г., Шик А. Я. Туннельный ток через контакт к двумерному электронному газу. 12, 2121
- Астахова Е. Ф., см. Омеляновская Н. М. 11, 2040
- Астрова Е. В., Лебедев А. А. Новый способ обработки спектров DLTS. 3, 549
- Атаев Ж., Васильев В. А., Волков А. С., Коньков О. И., Теруков Е. И. Влияние технологии приготовления пленок $\alpha-Si:H$ на излучательную рекомбинацию. 3, 488
- Атакулов Ш. Б., Онаркулов К. Э. Экспериментальное исследование фото-холл-эффекта в фоточувствительных поликристаллических слоях PbS. 10, 1884
- Ауслендер М. И., Бебенин Н. Г. Теория пьезосопроупвления в ферромагнитных полупроводниках $HgCr_2Se_4$ и $CdCr_2Se_4$ p -типа. 7, 1169
- Афанасьева Н. П., см. Андреев В. М. 3, 585
- Афанасьева Н. П., см. Гуцев Г. Л. 3, 479
- Афралов М. А., Баранов А. Н., Дмитриев А. П., Михайлова М. П., Сморгчкова Ю. П., Тимченко И. Н., Шерстнев В. В., Яковлев Ю. П., Яссевич И. Н. Узкозонные гетеропереходы II-типа в системе твердых растворов GaSb—InAs. 8, 1397
- Ахмедов А. А., см. Кязым-заде А. Г. 10, 1873
- Ахметов В. Д., Болотов В. В., Камаев Г. Н., Смирнов Л. С. Изменение концентрации атомов бора и фосфора в узлах решетки кремния при облучении электронами. 1, 72
- Ашкинадзе Б. М., Бельков В. В., Красинская А. Г. Микроволновый циклотронный резонанс в чистых кристаллах GaAs. 3, 572
- Ашкинадзе Б. М., Бельков В. В., Красинская А. Г. Воздействие горячих электронов на люминесценцию GaAs. 5, 883
- Ашмонтас С., Валушис Г., Либертис Ю., Субачюс Л. Шумовая температура в компенсированном $n-InSb\langle Cr \rangle$. 12, 2214
- Бабаходжаев У., см. Голикова О. А. 7, 1190
- Бабенцов В. Н., Буденная Л. Д., Горбань С. И., Друзь Б. Л., Евтухов Ю. Н. Изменение механизма локализации экситонов в $CdS_{1-x}Te_x$ при структурном преобразовании решетки. 2, 370
- Бабий П. И., Слынько В. В., Гнатенко Ю. П., Букивский П. Н., Илащук М. И., Парфенюк О. А. Изолэлектронные примеси замещения Sc и Ti в CdTe. 8, 1444
- Бабушкина Т. С., см. Аleshкин В. Я. 5, 892
- Бабушкина Т. С., см. Карпович И. А. 12, 2172
- Баграев Н. Т., Клячкин Л. Е., Маляренко А. М., Половцев И. С., Сухапов В. Л. Генерация и отжиг дефектов при совмещенном геттерировании в кремнии n -типа. I. Геттерирующие микродефекты. 9, 1557

- Баграев Н. Т., Клячкин Л. Е., Малайренко А. М., Половцев И. С., Суханов В. Л. Генерация и отжиг дефектов при совмещенном геттерировании в кремнии n -типа. II. Точечные дефекты, индуцированные геттерирующими микродефектами. 9, 1563
- Багратишвили Г. Д., Берозашвили Ю. Н., Джанелидзе М. Б., Джанелидзе Р. Б. Исследование плотности состояний в пленках аморфного германия. 6, 982
- Баженов Н. Л., Гельмонт Б. Л., Иванов-Омский В. И., Ижнин А. И., Смирнов В. А. Фотолюминесценция твердых растворов $Cd_{0.4}Hg_{0.6}Te$. 1, 93
- Базлов Н. В., см. Вывенко О. Ф. 12, 2208
- Балинас В., Гореленок А. Т., Кроткус А., Сталенис А., Шмидт Н. М. Измерение ВАХ $InGaAs$ при помощи пикосекундной электрооптической стробирующей установки. 5, 848
- Балтрамеюнас Р., Геразимас Э., Жукаускас А., Крюкова И. В., Теплицкий В. А., Юршенас С. Скорость рекомбинации неравновесной электронно-дырочной плазмы в лазерных кристаллах CdS . 9, 1550
- Банкина В. Ф., см. Коржуев М. А. 5, 805
- Банная В. Ф., Веселова Л. И., Гершензон Е. М., Гусинский Э. Н., Литвак-Горская Л. Б. Оценка точности метода определения раздельной концентрации примесей из измерений постоянной Холла. 12, 2145
- Банцегов С. В., см. Соколина Г. А. 1, 175
- Баранов А. Н., Воронина Т. И., Дахно А. Н., Джуртанов Б. Е., Лагунова Т. С., Сиповская М. А., Яковлев Ю. П. Кластерные образования в эпитаксиальных слоях твердых растворов $p-GaInSbAs$, выращенных на подложках $n-GaSb$: Te . 6, 1072
- Баранов А. Н., Дахно А. Н., Джуртанов Б. Е., Лагунова Т. С., Сиповская М. А., Яковлев Ю. П. Электрические и фотоэлектрические свойства твердых растворов $p-GaInSbAs$. 1, 98
- Баранов А. Н., см. Андаслава А. А. 10, 1708
- Баранов А. Н., см. Афраилов М. А. 8, 1397
- Баранов А. Н., см. Титков А. Н. 6, 1056
- Баранов И. А., Кучинский П. В., Ломако В. М., Петрунин А. П., Сепелевич С. О., Шахлевич Л. Н. Дефектообразование в кремнии, облученном частицами с массой ~ 400 а. е. м. п энергии до 100 МэВ. Спектроскопия дефектов. 4, 731
- Баранова Е. К., см. Александров П. А. 6, 1132
- Барановский С. Д., см. Абдукадыров А. Г. 1, 136
- Баранский П. И., Беляев А. Е., Боднарчук О. А., Горбатюк П. И., Комиренко С. М., Раренко П. М., Шевченко Н. В. Явления переноса и рекомбинации в твердых растворах $Mn_xHg_{1-x}Te$ ($x \sim 0.1$). 8, 1490
- Баранский П. И., Беляев А. Е., Городищный О. П., Комиренко С. М. Влияние пластической деформации на гальваномагнитные и фотоэлектрические свойства $n-Cd_xHg_{1-x}Te$. 1, 121
- Баркова Т. Б., см. Крутоголов Ю. К. 9, 1673
- Барышев Н. С., Гельмонт Б. Л., Ибрагимова М. И. Процессы рекомбинации носителей заряда в $Cd_xHg_{1-x}Te$ (обзор). 2, 209
- Барышев Н. С., Ибрагимова М. И., Хайбуллин И. Б. Рекомбинационные свойства кристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te(x \sim 0.2)$. 2, 363
- Басалаев Ю. М., Золотарев М. Л., Полягалов Ю. И., Поплавной А. С. Зонная структура, оптические свойства и распределение заряда валентных электронов в $CdSiAs_2$. 5, 916
- Батукова Л. М., см. Алешкин В. Я. 5, 892
- Бахадурханов М. К., см. Талипов Ф. М. 12, 2202
- Бахматюк Б. П., см. Григорчук И. И. 2, 386
- Бахышов А. Э., Натиг Б. А., Сафват Б., Самедов С. Р., Абабасов Ш. М. Электронные свойства кристаллов $TlGaSe_2$ и $TlInS_2$ в нестационарном режиме. 7, 1318
- Башаленивили З. В., см. Гарнык В. С. 8, 1485
- Бегбин Н. Г., см. Ауслендер М. И. 7, 1169
- Беднарский В. В., Верховодов М. П., Песка Г. П. Перенос неравновесных носителей заряда в вариозных структурах с учетом зависимости подвижности от состава твердого раствора. 8, 1371
- Белецкий В. И., см. Ганнимзаде Ф. М. 4, 673
- Белов А. Г., см. Елизаров А. И. 5, 923
- Белоконов С. А., см. Громовой Ю. С. 2, 250
- Белокурова И. Н., см. Семенюк Ю. А. 7, 1272
- Белоусов М. В., Гореленок А. Т., Давыдов В. Ю., Каржавин Р. В., Моклина И. А., Шмидт Н. М., Якименко И. Ю. Исследование влияния химической обработки InP на скорость поверхностной рекомбинации методом комбинационного рассеяния света. 12, 2177
- Бельков В. В., см. Ашкинадзе Б. М. 3, 572
- Бельков В. В., см. Ашкинадзе Б. М. 5, 883
- Беляев А. Е., Гавалешко Н. Н., Кривень С. И., Мазур Ю. И., Шевченко Н. В. Влияние обменного взаимодействия на осцилляции Шубникова—де-Гааза в полумагнитных твердых растворах $Hg_{1-x}Cd_xMn_ySe$. 11, 1999
- Беляев А. Е., см. Баранский П. И. 1, 121

- Беляев А. Е., см. Баранский П. И. 8, 1490
- Белянин А. Ф., см. Соколова Г. А. 1, 175
- Белянский М. П., Гаськов А. М., Дашевский З. М., Рожкова Е. В., Руленко М. П. $p-n$ -Переходы в PbS, полученные поппой имплантацией. 11, 2046
- Белянцев А. М., Романова Ю. Ю. Поперечный транспорт в дубарьерной гетероструктуре в условиях разогрева носителей. 4, 692
- Берковиц В. Л., Гольдберг Ю. А., Львова Т. В., Поссе Е. А., Хаспева Р. В. Влияние приповерхностного электрического поля на анизотропию оптического отражения поверхности (110) арсенида галлия. 2, 353
- Берковиц В. Л., Львова Т. В., Хаспева Р. В. Изгиб зон в арсениде галлия при формировании омического контакта (оптические исследования). 6, 1031
- Берман Л. С., Витовский Н. А., Воронков В. Б., Ломасов В. Н., Ткаченко В. Н. Влияние электрического поля на профиль концентрации радиационных дефектов в кремнии, облученном электронами с энергией вблизи порога дефектообразования. 7, 1243
- Берман Л. С., Витовский Н. А., Ломасов В. Н., Ткаченко В. Н. О природе K -центра в кремнии. 12, 2186
- Берман Л. С., Витовский Н. А., Ломасов В. Н., Ткаченко В. Н. Распределение атомов кремния на пороговой энергии смещения и его зависимость от температуры. 10, 1816
- Берман Л. С., Ломасов В. Н., Ткаченко В. Н. О применимости метода температурной зависимости емкости и активной проводимости для определения параметров глубоких центров в перекомпенсированном полупроводнике. 10, 1841
- Берозавилл Ю. Н., см. Багратишвили Г. Д. 6, 982
- Берт Н. А., Воробьева В. В., Воронцова М. В., Крещук А. М., Новиков С. В., Погребницкий К. Ю., Савельев И. Г., Сайфидинов Д. Ж., Сошников И. П., Шик А. Я. Влияние толщины верхнего узкозонного слоя на концентрацию двумерных электронов в инвертированных гетероструктурах $\text{InP}/\text{In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$. 4, 653
- Берченко Н. Н., см. Елизаров А. И. 3, 446
- Бирюлин Ю. Ф., Воробьева В. В., Новиков С. В., Шелковников Д. Н. Двойное легирование эпитаксиального GaAs извалентной примесью — висмутом и акцепторной примесью — цинком. 12, 2247
- Бирюлин Ю. Ф., Каряев В. Н., Крещук А. М., Писаревская В. А. Особенности электрофизических свойств GaAsSb, легированного амфотерной примесью — германием. 12, 2219
- Битюцкая Л. А., см. Вавилов В. С. 12, 2132
- Благовещенская Т. А., см. Филатова Е. О. 7, 1216
- Блок М. Д. Магнитофононные осцилляции проводимости с частотой коротковолнового акустического фона вблизи границы полупроводника. 3, 580
- Богатыренко Н. Г., см. Немов С. А. 8, 1391
- Богданов Е. В., Заставный Ю. В. Магнитофононный резонанс и эффект поперечного пробоя в сплавах $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ под давлением. 3, 565
- Богобойщиц В. В., см. Елизаров А. И. 3, 446
- Богобойщиц В. В., см. Елизаров А. И. 5, 923
- Боднарчук О. А., см. Баранский П. И. 8, 1490
- Боднарчук О. А., см. Глузман Н. Г. 10, 1766
- Болбошенко В. З., Иванова Г. Н., Калмыкова И., Касиян В. А., Недеогло Д. Д., Новиков Б. В. Влияние меди на спектры излучения кристаллов ZnSe. 11, 1929
- Болгов С. С., Владимирова В. В., Малютенко В. К., Савченко А. П. Виповая неустойчивость в варизонных полупроводниках. 9, 1598
- Болгов С. С., Малютенко В. К., Пипа В. И., Савченко А. П., Юнович А. Э. Люминесценция варизонных структур $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ в условиях магнитоцентрационного эффекта. 9, 1677
- Болгов С. С., см. Акопян А. А. 10, 1875
- Болдырев С. Н., Виленкин А. Я., Мордкович В. Н., Омельяновская Н. М., Саакян А. А. Влияние силовых полей на образование радиационных дефектов в кремнии при электронном облучении структур $\text{SiO}_2\text{—Si}$. 2, 300
- Болотов В. В., Камаев Г. Н., Феофанов Г. Н., Эмексузян В. М. Формирование структур с блокированной прыжковой проводимостью гидрогенизацией кремния, легированного галлием. 10, 1697
- Болотов В. В., см. Ахметов В. Д. 1, 72
- Бордовский Г. А., Каничев М. Р. Емкостная спектроскопия локализованных состояний в халькогенидных стеклообразных полупроводниках. 3, 527
- Бордовский Г. А., Савинова Н. А. Влияние сильного электрического поля на фотоэлектрические характеристики халькогенидного стеклообразного полупроводника $\text{As}_{40}\text{S}_{30}\text{Se}_{30}$. 2, 342
- Борисов А. В., см. Дубровский Ю. В. 5, 928
- Борисов В. С., см. Постников В. С. 5, 855
- Борисова Т. Л., Власукова Л. А., Нятикшис В. В., Норейка Д. П., Пятраускас М. Б., Станев Н., Утенко В. И., Хитко В. И. Влияние высокотемпературной термообработки на рекомбинационные и структурные свойства полупроводящего арсенида галлия. 11, 2005

- Босак В. И., Жевно А. Н., Стельмах В. Ф. Характер взаимодействия имплантированного в кремний гелия с атомами решетки. 3, 570
- Ботев А. А., см. Соколина Г. А. 1, 175
- Брандт Н. Б., Скипетров Е. П., Слынько Е. И., Хорош А. Г., Штанов В. И. Гальваномагнитные эффекты в сплаве p - $Pb_{1-x}Sn_xTe$ ($x=0.2$), облученном электронами. 1, 51
- Браташевский Ю. А., Николаенко Ю. М., Прозоровский В. Д., Несмелова И. М. О модели двухэлектронной проводимости в $Hg_{1-x}Cd_xTe$. 2, 305
- Бриллиантов Н. В., Вольский В. А., Квяткевич А. И., Тимошкин В. Н. Диффузия заряженных примесей в полупроводниках. Учет корреляционных эффектов и расчет изоконцентрационных коэффициентов диффузии. 5, 860
- Бродовой А. В., Бродовой В. А., Лашкарев Г. В. Магнитная восприимчивость примесей хрома в арсениде галлия. 9, 1684
- Бродовой В. А., см. Бродовой А. В. 9, 1684
- Брунков П. Н., Евтихьев В. П., Конников С. Г., Котельников Е. Ю., Пепенцев М. Г., Соболев М. М. Обнаружение нового метастабильного уровня $D\bar{X}$ -центра в тонких легированных Si слоях $Al_xGa_{1-x}As$. 11, 1978
- Брунков П. Н., Калининский В. С., Конников С. Г., Соболев М. М., Сулима О. В. Особенности поведения радиационных дефектов в структурах на основе $Al_xGa_{1-x}As/GaAs$. 7, 1320
- Бугаева Т. В., Гуляев Ю. В., Фукс Б. И., Чусов П. И. К теории акустической инжекции в пьезополупроводниковых p - n -переходах. 7, 1291
- Бударагин В. В., см. Александров П. А. 6, 1132
- Буденная Л. Д., см. Бабенцов В. Н. 2, 370
- Бузынин А. Н., Заболотский С. Е., Калининский В. П., Лукьянов А. Е., Мурина Т. М., Осико В. В., Плоппа М. Г., Татаринцев В. М., Эйдензон А. М. Крупномасштабные электрически активные примесные скопления в кристаллах кремния, выращенных методом Чохральского. 2, 264
- Буйлов Л. Л., см. Соколина Г. А. 1, 175
- Букалов В. Р., см. Федосов А. В. 4, 754
- Букивский П. Н., см. Бабий П. И. 8, 1444
- Булач Б. М., Кулиш Н. Р., Кунец В. П., Лисица М. П., Малыш Н. И. Динамический эффект Бурштейна—Мосса в монокристаллическом $CdSe$ и стекле КС-19. 2, 254
- Булах Б. М., см. Кулиш Н. Р. 1, 25
- Булах Г. И., Бурбело Р. М., Гуляев А. Л., Кучеров И. Я. Фотоакустическая микроскопия эпитаксиальных кремниевых структур. 5, 926
- Бумай Ю. А., Ульяшин А. Г., Щакун И. А., Шлопак Н. В. Влияние обработки в водородной плазме на электрофизические свойства кремния, легированного фосфором. 12, 2141
- Бумялене С., Пирагас К., Ченис А. Исследование размерности странного аттрактора и амплитудного порога синхронизации хаотических автоколебаний фототока в n - $Ge(Ni)$. 9, 1509
- Бунин Г. Г., см. Дубровский Ю. В. 5, 928
- Бурбело Р. М., см. Булах Г. И. 5, 926
- Бурдиян П. П., см. Амброс В. П. 8, 1375
- Бутусов Д. М., Гоцадзе Г. Г., Рывкин Б. С., Сурис Р. А. Внутреннее перераспределение электрического поля и оптическая нелинейность в P - i - N -гетероструктурах при электропоглощении света. 6, 1062
- Быковский В. А., Иванютин Л. А., Кольченко Т. П., Ломако В. М., Цыпленков И. Н., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. Особенности поведения изovalентной примеси индия при легировании арсенида галлия в процессе газофазовой эпитаксии из металлоорганических соединений. 1, 77
- Быковский В. А., Кольченко Т. П., Ломако В. М. Фотоломинесценция эпитаксиальных слоев $GaAs$: In, полученных хлоридным методом. 12, 2117
- Быковский В. А., см. Акулович Н. И. 3, 472
- Быковский В. Ю., Вовненко В. И., Дмитрук Н. Л., Свечников С. В. Влияние анизотропного травления на глубокие уровни в приповерхностной области арсенида галлия. 2, 287
- Бычковский Д. Н., Константинов О. В., Царенков Б. В. Гетеропереход, возникающий на границе скачкообразного изменения концентрации свободных носителей в однородном по составу полупроводнике. 10, 1848
- Вавилов В. С., Чукичев М. В., Хакимов К., Битюцкая Л. А., Китин Д. В., Хухрянский М. Ю. Исследование спектров катодоломинесценции кристаллов моноклинного дифосфида цинка, легированного медью. 12, 2132
- Вавилов С. Е., Гречко Л. Г., Левандовский В. Г., Мальнев В. Н., Чайка Е. Г. Горячие экситоны в области неоднородного электрического поля. 2, 379
- Вагидов Н. З., Грибников З. С., Иващенко В. М. Моделирование электронов в реальном пространстве гетероструктуры $GaAs/Al_xGa_{1-x}As$ (для малых и больших значений x). 6, 1087
- Вайткус Ю., Томашюнас Р., Тумкявичюс К., Пятраускас М., Мастейка Р. Пикосекундная фотопроводимость поликристаллических пленок $PbTe$ на неоднородных и ориентирующих подложках. 11, 1919
- Валах М. Я., см. Артамопов В. В. 10, 1747
- Валейко М. В., Засавицкий П. И., Мацинашвили Б. Н.,

- Рухадзе З. А., Ширков А. В. Квантово-размерный и деформационный эффекты в структурах на основе $PbSe/Pb_{1-x}Eu_xSe$, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 8, 1437
- Вадулис Г., см. Ашмонтас С. 12, 2214
- Ван Си-фу, Син Сюй, Цзян Вэй. Расчет аномального эффекта Холла при комнатной температуре в термообработанном образце n -Ge. 4, 631
- Ванем Р. А., Киккин К. А., Мессерер М. А., Перлова Л. Я. Оптические переходы в GaAs, легированном кислородом и хромом. 10, 1827
- Варванин Н. А., Губанков В. Н., Котельников И. Н., Медведев Б. К., Мокеров В. Г., Мордовец Н. А. Фотопроводимость в области циклотронного резонанса двумерного электронного газа в GaAs/AlGaAs при больших факторах заполнения. 4, 635
- Варданын Р. Р., Клячкин Л. Е., Суханов В. Л. Четный магнитный фотоэффект в структурах с p - n -переходом цилиндрической формы. 3, 485
- Варламов И. Б., см. Солдатов В. С. 9, 1611
- Варламов И. В., см. Ильичев Э. А. 5, 788
- Варламов И. В., см. Ильичев Э. А. 6, 978
- Васильев А. М., см. Андреев В. М. 7, 1194
- Васильев В. А., Волков А. С., Мусабеков Е., Теруков Е. И., Челноков В. Е., Чернышев С. В., Шерняков Ю. М. Фотолюминесценция пленок α - $Si_{1-x}C_x$: Н. 4, 710
- Васильев В. А., Дышловенко П. Е., Копылов А. А., Лютович К. Л. Примесная фотопроводимость эпитаксиальных слоев Ge_xSi_{1-x} , легированных фосфором. 9, 1675
- Васильев В. А., см. Атаев Ж. 3, 488
- Васильев В. П., Гельмонт Б. Л., Голубев В. Г., Иванов Омский В. И., Кропотов Г. И. Зеемановское расщепление ZF_3 -состояния мейкко акцепторов в германии. 1, 196
- Васько Ф. Т. Поляризованная субмиллиметровая люминесценция горячих дырок. 4, 682
- Васько Ф. Т., Стебловский Г. И. Поляризованная люминесценция размерно-квантованных гетероструктур. 1, 59
- Васько Ф. Т., Стриха М. В. Междзонные ИК переходы в одноосно деформированном узкощелевом полупроводнике. 7, 1227
- Ващенко В. А., Кернер Б. С., Осипов В. В., Синкевич В. Ф. Возбуждение и эволюция микроплазм — пычковых автосолютонов в кремниевых p - i - n -структурах. 10, 1705
- Веденеев А. С., Дмитриев С. Г., Рыльков В. В., Шагимуратов О. Г. Влияние поперечного градиента концентрации носителей заряда на распределение холловского потенциала в полупроводнике. 6, 1141
- Вейс А. Н., Дашевский З. М., Руленко М. П. Исследование коэффициента поглощения в $PbTe$, имплантированном цинком. 1, 126
- Вейс А. Н., см. Алексеева Г. Т. 12, 2155
- Велиев З. А. Термическая ионизация дырок из дислокационного центра в электрическом поле. 3, 553
- Велиюлин Э. И., Кахраманов С. Ш., Евстигнеев А. М., Автотшук В. В. Проявление эффектов межслоевого взаимодействия в спектрах электроотражения кристаллов $(Bi_2Te_3)_x(Bi_2Se_3)_{1-x}$. 11, 2060
- Велиюлин Э. И., см. Авакянц Л. П. 1, 193
- Верховодов М. П., см. Бедварский В. В., 8, 1374
- Веселова Л. И., см. Банная В. Ф. 12, 2145
- Викунин И. М., Глауберман М. А., Канишева Н. А., Козел В. В. Тирнстор, переключаемый магнитным полем. 11, 1959
- Викунин И. М., см. Курмашев Ш. Д. 3, 558
- Виленьки А. Я., см. Болдырев С. Н. 2, 300
- Винник Е. В., Глинчук К. Д., Гуровшев В. И., Прохорович А. В. Понижение температурной стабильности комплексов $V_{As}Zn_{Ga}$ в GaAs при нейтронном облучении. 8, 1363
- Виноградов А. С., см. Филатова Е. О. 7, 1216
- Виолин Э. И., см. Андреев А. П. 5, 821
- Вирро А. Л., Лыук П. А., Раммо И. Х.-Ф., Фридентал Я. К., Халлер Ю. Э. Влияние утечки электронов на пороговый ток $AlGaAs/Sb/GaSb$ инжекционных гетеролазеров. 7, 1158
- Витман Р. Ф., Витовский Н. А., Лебедев А. А., Машовец Т. В., Налбандян Л. В. «Проявление» скопления атомов электрически неактивных примесей в n -кремнии при γ -облучении. 1, 45
- Витовский Н. А., см. Берман Л. С. 7, 1213
- Витовский Н. А., см. Берман Л. С. 10, 1816
- Витовский Н. А., см. Берман Л. С. 12, 2186
- Витовский Н. А., см. Витман Р. Ф. 1, 45
- Витусевич С. А., см. Аюпян А. А. 8, 1424
- Владимиров В. В., Каплан Б. И., Коллюх А. Г., Малютенко В. К. Отрицательная фотопроводимость на пороге возбуждения винтовой неустойчивости в плазме полупроводников. 8, 1449
- Владимиров В. В., Каплан Б. И., Коллюх А. Г., Малютенко В. К., Щедрин А. И. Самостабилизация винтовых волн в полупроводниках. 11, 1995
- Владимиров В. В., см. Болгов С. С. 9, 1598
- Власукова Л. А., см. Борцова Т. Л. 11, 2005
- Вовненко В. И., см. Быковский В. Ю. 2, 287
- Воеводин А. Г., см. Солдатов В. С. 9, 1611

- оевдин Е. Н., Гершензон Е. М., Гольцман Г. Н., Птици-на Н. Г. Влияние магнитного поля на захват свободных носителей мелкими примесями в Ge. 10, 1881
- олков А. С., см. Атаев Ж. 3, 488
- олков А. С., см. Васильев В. А. 4, 710
- олков Д. А., Фистуль В. И. Топологическая оценка вероятности образования собственных точечных дефектов в кристаллах $A^{III}B^V$ со структурой сфалерита. 3, 475
- олкова Е. С., см. Горн И. А. 3, 538
- ольский В. А., см. Бриллиантов Н. В. 5, 860
- оробкало Ф. М., см. Хируненко Л. Н. 6, 1051
- оробьева В. В., Крещук А. М., Макарова Т. Л., Новиков С. В., Погребички К. Ю., Савельев И. Г. Изучение переходной области между эпитаксиальными слоями InP и $In_{0.53}Ga_{0.17}As$ в гетероструктурах с $2M\bar{3}G$. 6, 1026
- оробьева В. В., см. Берт Н. А. 4, 653
- оробьева В. В., см. Бирюлин Ю. Ф. 12, 2217
- оропина Т. П., см. Баранов А. Н. 6, 1072
- оронков В. Б., см. Берман Л. С. 7, 1213
- оронков В. П., Гурченко Г. А. Диффузия примеси в полупроводниках при импульсном лазерном отжиге. 10, 1831
- оронцова М. В., см. Берт Н. А. 4, 653
- оскобойников А. М., Смоляр В. В., Скрышевский В. А., Стриха В. И. Зависимость эффективной высоты потенциального барьера в $M-TD-P$ структурах при инфракрасной подсветке. 3, 413
- ывенко О. Ф., Базлов Н. В., Целищев С. Л. Об определении энергии ионизации глубоких уровней из данных DLTS. 12, 2208
- ывенко О. Ф., Истратов А. А., Хлебков А. Г. Двухзарядный метастабильный центр, обусловленный дислокациями в CdS . 9, 1650
- ыграненко Ю. К., Гук В. В. Поляризация внутривозного излучения в многодолинном полупроводнике (внутридолинное излучение). * 8, 1497
- ыграненко Ю. К., Гук В. В., Солончук И. В. Поляризация внутривозного излучения при изотропии функции распределения носителей в однодолинном полупроводнике. * 2, 392
- язовский М. В. Усиление гиперзвука при межпримесном поглощении света в полупроводниках. 5, 933
- яткин А. П., Крылова И. В., Максимова Н. К., Филонов Н. Г., Филатов В. И. Тензоэлектрические явления в контактах металл-арсенид галлия при анизотропном давлении. 1, 109
- авалешко Н. Н., см. Беляев А. Е. 11, 1999
- Гавриленко В. И., Калугин Н. Г., Красильник З. Ф., Никоноров В. В., Стариков Е. В., Шикторов П. Н. Циклотронный резонанс дырок германия с отрицательными массами при $H \parallel [001]$. 5, 825
- Гаврилов Ф. Ф., см. Оконечников А. П. 4, 747
- Гаврилюк С. В., см. Григорчак И. И. 2, 386
- Гаджиев А. Р., см. Тагиев Б. Г. 8, 1497
- Гальперин Ю. М., Гершензон Е. М., Дричко И. Л., Литвак-Горская Л. Б. Кинетические явления в конденсированном $n-InSb$ при низких температурах (обзор). 1, 3
- Гарасим В. И., Горлой П. Н., Деркач Н. П., Заячук Д. М. Подвижность и механизмы рассеяния дырок в $Pb_{0.92}Sn_{0.08}S_{0.8}Se_{0.2}$. 12, 2102
- Гарасим В. И., Заячук Д. М. Кинетические свойства твердых растворов $Pb_{1-x}Sn_xS_{1-x}Se_y$ ($x=0.19, y=0.5$ и 0.98). 3, 533
- Гарбар Н. П., см. Лукьянчикова Н. Б. 9, 1659
- Гарнык В. С., Башалейшвили З. В. Влияние глубоких уровней на время жизни неосновных носителей заряда. 8, 1485
- Гасанова Ф. А., см. Кязым-заде А. Г. 10, 1873
- Гаськов А. М., см. Белянский М. П. 11, 2046
- Гаубас Э., Гривицкас В., Земко А. Е., Каняева А., Салманов А. Р. Влияние высших мод затухания на эффективное время жизни фотовозбужденных носителей в кремнии. * 4, 773
- Гафийчук В. В., Дацко Б. И., Кернер Б. С., Осипов В. В. Микроплазмы в идеально однородных $p-i-n$ -структурах. 4, 724
- Гафийчук В. В., Дацко Б. И., Кернер Б. С., Осипов В. В. Спонтанное образование и эволюция локальных областей ударной ионизации в идеально однородных $p-n$ -структурах. 7, 1282
- Гашимзаде Ф. М., Надирзаде Р. С., Исмаилов Т. Г., Белецкий В. И., Павлов С. Т. Резонансное межзонное комбинационное рассеяние света в полумагнитном полупроводнике. 4, 673
- Гельмонт Б. Л., Родина А. В., Эфрос Ал. Л. Энергия связи дырки с нейтральным акцептором в алмазоподобных полупроводниках. 1, 198
- Гельмонт Б. Л., см. Баженов Н. Л. 1, 93
- Гельмонт Б. Л., см. Барышев Н. С. 2, 209
- Гельмонт Б. Л., см. Васильев В. П. 1, 196
- Генкин Г. М., Ноздри Ю. Н., Окомельков А. В., Шастиг В. Н. Исследование $n-HgTe$ в сильных электрических полях. 9, 1616
- Георгиев Е. И., Иванов-Омский В. И., Мастеров В. Ф., Погорлецкий В. М., Пиот-

- ровский Т., Смирнов В. А. Фотолуминесценция $Hg_{1-x}Mn_xTe$, связанная с локальным уровнем. Мп⁺. 12, 2160
- Георгицэ Е. И., Иванов-Омский В. И., Мовилэ В. Ф., Цыпшкэ Д. И. Циклотронный и комбинированный резонансы в полуметаллических твердых растворах $Hg_{1-x-y}Cd_xMn_yTe$. 10, 1823
- Георгицэ Е. И., Иванов-Омский В. И., Погорлецкий В. М., Пиотровский Т., Смирнов В. А. Фотопроводимость $p-Mn_xHg_{1-x}Te$ в магнитном поле. 10, 1732
- Георгицэ Е. И., см. Амброс В. П. 8, 1375
- Герасимас Э., см. Балтрамеюнас Р. 9, 1550
- Герасименко Н. Н., Зайцев Б. А., Таскин А. А., Тишковский Е. Г. О пространственном распределении электрически активных центров в кремнии, легированном селеном.* 2, 391
- Герасименко Н. Н., Курьшев Г. Л., Мясников А. М., Ободников В. И., Сафронов Л. Н., Хрящев Г. С. Электрофизические свойства планарных n^+-p -переходов, созданных легированием арсенида индия ионами серы. 7, 1245
- Герасименко Н. Н., см. Мякенькая Г. С. 6, 1042
- Герасименко Н. Н., см. Стась В. Ф. 3, 512
- Гергель В. А., Пльичев Э. А., Лукьянченко А. И., Полторацкий Э. А., Соляков А. Н. Физическая модель эффекта управления полевым транзистором через полупроводящую подложку. 12, 2411
- Германенко А. В., Ларионов В. А. Определение констант деформационного потенциала в $HgCdTe$. 10, 1762
- Гермогенов В. П., Отман Я. И., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В., Эпикетова Л. Е. Подавление «природных» акцепторов в GaSb путем изовалентного легирования висмутом. 6, 1095
- Гертович Т. С., Гринева С. И., Комиссаров Г. П., Манассон В. А., Огородник А. Д., Товстюк К. Д., Шарлай Е. С. Поляриметрический фотоприемник. 1, 192
- Гершензон Е. М., см. Банная В. Ф. 12, 2145
- Гершензон Е. М., см. Воеводин Е. И. 10, 1881
- Гершензон Е. М., см. Гальперин Ю. М. 1, 3
- Гибадатов И. Ю., см. Глебов А. С. 5, 941
- Гицу Д. В., Гринчешев И. Н., Зайковский А. В. Электрические и спектральные характеристики структур $Au-n-TlSbS_2$. 2, 382
- Гицу Д. В., Долма В. А., Мунтяну Ф. М., Пономарев Я. Г. Электронные фазовые переходы полупроводник-полуметалл в магнитном поле у тонких монокристаллических нитей сплавов $Bi-Sb$. 12, 2205
- Глазов В. М., Ким С. Г. Распространение ультразвука в жидком кремнии. 10, 1790
- Глауберман М. А., см. Викулиев И. М. 11, 1959
- Глебов А. С., Гибадатов И. Ю. Исследование плотности состояний в аморфной пленке ХСП методом ТОПЗ.* 5, 941
- Глебов С. С., Егоров В. В., Капустин Ю. А., Колокольников Б. М., Свешников А. А. Глубокие уровни дефектов, возникающих в структурах $Si-Pl_4Si_3$ в результате воздействия импульсной фотонной обработки. 9, 1689
- Глинчук К. Д., Литовченко Н. М., Птицын В. Ю. Некоторые свойства индуцированных криволинейно-комбинационных центров в термообработанном кремнии. 9, 1685
- Глинчук К. Д., см. Винник Е. В. 8, 1363
- Глобус Т. Р., Олеск А. О., Олеск С. А. Оптические характеристики $PbSe$. Переходы в высние зоны. 1, 37
- Глозштейн Ю. М., Манкевич Ю. Л. Взаимная сортировка электронов и фононов по энергиям электрон-фононного увлечения. 3, 544
- Глузман Н. Г., Лерпина Н. К., Сабирзянова Л. Д., Боднарчук О. А., Горбатюк И. Н., Раренко И. М. Особенности гальваномагнитных эффектов в $Hg_{1-x-y}Cd_xMn_yTe$ при переходе металл-диэлектрик. 10, 1766
- Гнатенко Ю. П., см. Бабий П. И. 8, 1444
- Голик Л. Л., Гутман М. М., Паксеев В. Е. Бифуркации удвоения периода в хаос в модели температурно-электрической неустойчивости в полупроводнике с двумя уровнями прилипания. 7, 1259
- Голикова О. А., Бабаходжаев У., Казанин М. М., Мездрогина М. М., Арлаускас К., Юшка Г. Удельные сдвиги носителей заряда и фотопроводимость аморфного гидрированного кремния. 7, 1190
- Голикова О. А., Заец А. И., Казанин М. М., Петров И. Н. Исследование переноса дырок в аморфном гидрированном кремнии методом видикола. 4, 768
- Голубев В. Г., см. Васильев В. П. 1, 196
- Гольдберг Ю. А., Львова Т. В., Мезрин О. А., Трошков С. И., Царенков Б. В. Коротковолновая фоточувствительность поверхностно-барьерных структур GaAs. 10, 1835
- Гольдберг Ю. А., см. Берковин В. Л. 2, 353
- Гольдман Е. И., Ждан А. Г., Клочков А. М., Маркин Ю. В. Полевая релаксационная спектроскопия локализованных электронных состояний в системах полупроводник-диэлектрик. 1, 159
- Гольдман Е. И., Ждан А. Г., Сумарока А. М. Проявление дискретных уровней при релаксационной спектроскопии локализованных электрон-

- ных состояний с непрерывным спектром. 3, 503
- Гольдфарб М. В., Молоцкий М. И. Электронное взаимодействие доноров с дислокацией. 7, 1330
- Гольдфарб М. В., Молоцкий М. И. Электронная структура примеси на дислокации. 11, 1948
- Гольцман Г. Н., см. Воеводин Е. И. 10, 1881
- Гончарова А. Г., Зуев В. В. Особенности температурной зависимости концентрации свободных носителей в полупроводнике, содержащем амфотерную U-примесь. 4, 660
- Горбань С. И., см. Бабенцов В. Н. 2, 370
- Горбатюк И. И., см. Баранский П. И. 8, 1490
- Горбатюк И. И., см. Глазман Н. Г. 10, 1766
- Гореленок А. Т., см. Балнас В. 5, 848
- Гореленок А. Т., см. Белоусов М. В. 12, 2177
- Гореленок А. Т., см. Дерингас А. 12, 2167
- Гордей П. Н., см. Гарасим В. И. 12, 2102
- Горн И. А., Мартынов В. И., Волкова Е. С., Гринев В. И. Фотолюминесценция и фото-ЭПР высокочистого селенида цинка, облученного электронами. 3, 538
- Городилов Н. А., Доманская Л. И., Нейфельд Э. А., Шелушнина Н. Г. Термоэзе теллурида ртути в магнитном поле. 4, 664
- Городничий О. П., см. Баранский П. И. 1, 121
- Горфинкель В. Б., Филатов И. И. Разогрев электронного газа высокочастотным электрическим полем в активной области полупроводникового гетеролазера. 4, 742
- Горюнов Н. Н., см. Крылов Д. Г. 6, 997
- Горя О. С., Ковалева Л. Е., Коротков В. А., Маликова Л. В., Симашкевич А. В. Исправление к статье «Спектральная память фотопроводимости высокоомного ZnSe» (ФТП. 1989. Т. 23. В. 11. С. 2090—2093). 8, 1496
- Гоцадзе Г. Г., см. Бутусов Д. М. 6, 1062
- Грессеров Б. Н., Мнацаканов Т. Т. Оценка роли электронно-дырочного рассеяния в переносе носителей заряда в многослойных арсенид-галлиевых структурах. 9, 1668
- Грехов И. В., Делимова Л. А., Шубников М. Л. Влияние гидростатического сжатия на рекомбинационные свойства золота в Si. 12, 2203
- Гречко В. А., см. Малик А. И. 12, 2191
- Гречко Л. Г., см. Вавилов В. С. 2, 379
- Грибников З. С., Железняк В. Б. Двумерные ганновские домены в слоистых структурах. 3, 401
- Грибников З. С., Райчев О. Э. GX-перенос в реальном пространстве: N-ОДП в слоистой структуре. 5, 940
- Грибников З. С., Райчев О. Э. Инверсия двойного заряженного слоя при прямом смещении слабопрозрачного изотипного гетероперехода. 7, 1222
- Грибников З. С., Райчев О. Э. Перенос электронов через перекрестный GX-гетеропереход. 10, 1772
- Грибников З. С., см. Вагидов И. З. 6, 1087
- Гривницас В., см. Гаубас Э. 4, 773
- Григорчак И. И., Петяга В. В., Вахматов Б. П., Гаврилюк С. В., Ковалюк З. Д., Марчук И. З. Особенности изменения физических свойств InSe итеркалпированием хлором. 2, 386
- Григорьев В. В., Зуев В. В., Мехтиев М. М., Петровский А. Н., Сальник А. О. О влиянии рекомбинации носителей заряда на параметры сигнала в методе фотодефлекционной спектроскопии. 11, 2031
- Григорьев Н. П., Кудыкина Т. А., Любченко А. В. Кинетика нарастания и спада концентрации носителей при импульсном фотовозбуждении неоднородных полупроводников. 1, 190
- Гринев В. И., см. Гори П. А. 3, 538
- Гринева С. И., см. Гертович Т. С. 1, 192
- Гринчешен И. И., см. Гицу Д. В. 2, 382
- Громовой Ю. С., Коровина Л. А., Пляцко С. В., Сизоф Ф. Ф., Дарчук С. Д., Белоконь С. А. Проявление донорного характера примеси в монокристаллах RbTe:Ti под действием ИК лазерного излучения. 2, 250
- Грушка Г. Г., см. Малик А. И. 12, 2191
- Губанков В. Н., см. Варванин Н. А. 4, 635
- Гуга К. Ю., см. Малютенко В. К. 8, 1467
- Гузъ В. Н., Жадько И. П., Козловский С. И., Романов В. А. Перераспределение электрического потенциала в искусственно анизотропной (по электропроводности) полупроводниковой пластине с кольцевыми электродами. 3, 409
- Гук В. В., см. Выграненко Ю. К. 2, 392
- Гук В. В., см. Выграненко Ю. К. 8, 1497
- Гук Е. Г., Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. Эффект немопотной зависимости шума $1/f$ от интенсивности подсетки в Si и модель объемного шума $1/f$ в полупроводниках. 5, 813
- Гуляев А. Л., см. Булах Г. И. 5, 926
- Гуляев Ю. В., см. Бугасва Т. В. 7, 1291
- Гуревич Ю. Г., Логвинов Г. Н. Функция распределения (ФР) электронов в субмикронных слоях в греющих электрических полях. 10, 1715
- Гуревич Ю. Г., Машкевич О. Л. К теории термоэлектрических явлений в биполярных полупроводниках. 7, 1327

- Гурьева Е. А., см. Алексеева Г. Т. 12, 2155
- Гурушев В. И., см. Винник Е. В. 8, 1363
- Гуртов В. А., Назаров А. И., Травков И. В. Моделирование процесса накопления объемного заряда в диэлектриках МДП структур при облучении. 6, 969
- Гурченко Г. А., см. Воронков В. П. 10, 1831
- Гусев М. Ю., Дмитриев А. И., Зюганов А. Н., Ковалюк З. Д., Лазоренко В. И., Лашкарев Г. В., Смертенко П. С. Отрицательная дифференциальная проводимость монокристаллов InSe в диапазоне температур 4.2—30 К. 8, 1413
- Гусейнов А. А., см. Андаспаева А. А. 10, 1708
- Гусейнов А. А., см. Титков А. И. 6, 1056
- Гусинский Э. Н., см. Банная В. Ф. 12, 2145
- Гуткин А. А., см. Аверкиев Н. С. 9, 1632
- Гутман М. М., см. Голик Л. Л. 7, 1259
- Гуцев Г. Л., Мякенькая Г. С., Афанасьева Н. П., Коноплева Р. Ф. Изучение комплексов бора и кислорода с литием в компенсированном кремнии. 3, 479
- Гуцев Г. Л., см. Мякенькая Г. С. 6, 1042
- Гярулайтис Д. А., Намаюнас А. М., Тамашявичене З. Н., Тамашявичюс А. В. Влияние радиационных дефектов на вероятность включения искусственных микроплазм в кремнии. 3, 563
- Давыдов В. Ю., см. Белоусов М. В. 12, 2177
- Далуда Ю. Н., см. Емцев В. В. 2, 374
- Данагулян С. С., см. Аветисян С. К. 8, 1421
- Дарчук С. Д., см. Громовой Ю. С. 2, 250
- Дахно А. Н., см. Баранов А. Н. 1, 98
- Дахно А. Н., см. Баранов А. Н. 6, 1072
- Дацко Б. И., см. Гафийчук В. В. 4, 724
- Дацко Б. И., см. Гафийчук В. В. 7, 1282
- Дашевский З. М., см. Белянский М. П. 11, 2046
- Дашевский З. М., см. Вейс А. Н. 1, 126
- Дашевский М. Я., Корляков Д. Н., Ладыгин Е. А., Мусалитин А. М., Шилин Б. А. Влияние облучения электронами на физические свойства легированных германием монокристаллов кремния. 12, 2073
- Двуреченский А. В., см. Каранович А. А. 6, 1101
- Дедулевич С., Канцлерис Ж. Исследование эффекта охлаждения и нагрева светом в р-Ge. 3, 427
- Делимова Л. А., см. Грехов И. В. 12, 2203
- Демаков К. Д., см. Александров П. А. 6, 1132
- Демидов В. В., см. Алешкин В. Я. 5, 892
- Демидовский С. В., Муравьев А. В., Павлов С. Г., Шастин В. Н. Перестройка спектра излучения лазера на р-Ge при одноосной деформации. 12, 2151
- Демчук Д. Л., см. Супрунчик В. В. 6, 1014
- Денис В., Мартунас З., Шятакус А. Электропроводность $n^+ - n^-$ -структур GaAs микронной и субмикронной длин в слабо греющем электрическом поле. 4, 720
- Денисенко В. Л., Опанасюк А. С., Рощупкин С. П. Влияние спин-орбитального взаимодействия на зонную структуру сверхрешеток HgTe—CdTe.* 5, 941
- Дернигас А., Добровольский З., Гореленок А. Т., Мокина И. А., Шмидт Н. М. Исследование кинетики фотопроводимости в коротких фоторезисторах на основе InP:Fe. 12, 2167
- Держач Н. И., см. Гарасим В. И. 12, 2102
- Дерябина Т. И., Кулаев Г. И., Раданцев В. Ф. Двумерный электронный газ в инверсионных слоях HgTe. 7, 1182
- Дехтяр Ю. Д., Носков В. А., Саввантова Ю. А., Сагалович Г. Л. Образование и отжиг вакансионных комплексов в поверхностном слое монокристаллического кремния, облученного ионами средней массы. 3, 492
- Дехтяр Ю. Д., Сигалович Г. Л. Кинетика дефектообразования в кремнии при имплантации в него ионов фосфора. 4, 757
- Джамагидзе Ш. З., Жагвилава Т. А., Швангирадзе Р. Р. О коэффициенте термоэдс в эпитаксиальной структуре GaP. 9, 1670
- Джаманбалин К. К., Дмитриев А. Г. Эволюция барьерного контакта GaAs—Ni в омический при воздействии лазерного излучения. 11, 2024
- Джаманбалин К. К., Дмитриев А. Г., Поссе Е. А., Шульга М. И. Ток туннельного типа в поверхностно-барьерных структурах на основе слабо легированного арсенида галлия. 12, 2089
- Джанелидзе М. Б., см. Багратишвили Г. Д. 6, 982
- Джанелидзе Р. Б., см. Багратишвили Г. Д. 6, 982
- Джумамухамбетов Н. Г., см. Андреева В. Д. 6, 1010
- Джуртанов Б. Е., см. Баранов А. Н. 1, 98
- Джуртанов Б. Е., см. Баранов А. Н. 6, 1072
- Диордиев С. А., см. Крутоголов Ю. К. 9, 1673
- Дмитриев А. Г., см. Андреева В. Д. 6, 1010
- Дмитриев А. Г., см. Джаманбалин К. К. 11, 2024
- Дмитриев А. Г., см. Джаманбалин К. К. 12, 2089
- Дмитриев А. И., см. Гусев М. Ю. 8, 1413

- Дмитриев А. П., Имамов Э. З., Яссыевич И. Н. Резонанс Фано эффекта увлечения электронов фотонами в полупроводниках. 12, 2193
- Дмитриев А. П., см. Афраймов М. А. 8, 1397
- Дмитриев В. В., Скипетров Е. П. Глубокий радиационный уровень в антимониде индия n -типа, облученном электронами. 5, 897
- Дмитриев С. Г., см. Веденцев А. С. 6, 1141
- Дмитрук Н. Л., см. Быковский В. Ю. 2, 287
- Доброго В. П., Доросинец В. А. Электропроводность сильно легированного сильно компенсированного (СЛК) арсенида галлия. * 4, 772
- Доброго В. П., Ермолаев О. П., Хемеда О. М. Переход Мотта в германии с радиационными дефектами. 3, 555
- Добровольский В. Н., Ловейко В. Н., Никидзе Г. К., Петрусенко В. Н. Проводимость МТДП структур в режиме без накопления неосновных носителей заряда. 6, 1067
- Добровольский В. Н., Сырых А. Д. Дуальные датчики Холла. 6, 1103
- Добровольский З., см. Дерингас А. 12, 2167
- Довгий Я. О., Китык И. В., Маньковская И. Г., Евстигнеев Л. Н. Поляризованные оптические спектры монокристаллов Tl_3SbS_3 . 9, 1608
- Долма В. А., см. Гицу Д. В. 12, 2205
- Долманов И. Н., Рыжий В. П., Толстихин В. И. Кинетические эффекты в инжекторе с резонансным туннелированием электронов. 9, 1574
- Долманов И. Н., Толстихин В. И. Электроадсорбционная оптическая бициальность в волноводной $P-i-N$ ДГС с туннельно резонансной нагрузкой. 2, 334
- Доманская Л. И., см. Городилов Н. А. 4, 664
- Доника Ф. Г., см. Радауцан С. И. 9, 1592
- Доросинец В. А., см. Доброго В. П. 4, 772
- Дощанов К. М. Механизм АФН эффекта в поликристаллических полупроводниках. 7, 1251
- Дощанов К. М., Соколов В. Д. Фотопроводимость и генерация фотоэда в полупроводниковом бикристалле. 8, 1407
- Дрычко И. Л., см. Гальперин Ю. М. 1, 3
- Друзь Б. Л., см. Бабенцов В. Н. 2, 370
- Дубков В. П., Скипетров Е. П. Влияние давления на электрофизические свойства $Pb_{1-x}Sn_xSe$ ($x=0.25$), облученного электронами, в диэлектрической фазе. 1, 104
- Дубров И. Н., Козловский С. И., Коростышевский Ю. М., Моеин М. Д. Фотомагнитный эффект в кристаллах изолирующего арсенида галлия при лазерном возбуждении. 4, 763
- Дубровский Ю. В., Ларкин И. А., Морозов С. В., Борисов А. В., Бунии Г. Г., Иноземцев С. А., Ланин В. Г., Малахов Б. А. «Энергетическая квазибаллистика» в микроструктурах на GaAs при низких температурах. 5, 928
- Дьяконова Н. В., Левишштейн М. Е., Плоткин Д. А., Румянцев С. Л. Кинетика спада долговременной фотопроводимости в GaAs и модель объемного шума $1/f$ в полупроводниках. 5, 836
- Дьяконова Н. В., Левишштейн М. Е., Румянцев С. Л. Исследование долговременной релаксации фотопроводимости в Si в связи с проблемой шума $1/f$. 9, 1531
- Дьяконова Н. В., см. Гук Е. Г. 5, 813
- Дымова Н. Н., см. Акимченко И. П. 10, 1857
- Дынин Е. А. Статистические моменты при квантовом туннелировании. 4, 764
- Дышловенов П. Е., см. Васильев В. А. 9, 1675
- Дякону И. П., см. Мусатов А. Л. 9, 1523
- Евстигнеев А. М., см. Велиулин Э. И. 11, 2060
- Евстигнеев Л. Н., см. Довгий Я. О. 9, 1608
- Евтихийев В. П., см. Брунков П. Н. 11, 1978
- Евтухов Ю. Н., см. Бабенцов В. Н. 2, 370
- Егоров В. В., см. Глебов С. С. 9, 1689
- Ежевский А. А., Аммерлаан С. А. Дж. Электронный парамагнитный резонанс комплексов $FeFeV$ в кремнии. 8, 1354
- Елизаров А. П., Богобоящий В. В., Белов А. Г. Вольт-амперные характеристики потенциальных барьеров в гетероструктурах $Cd_xHg_{1-x}Te/CdTe$. 5, 923
- Елизаров А. П., Богобоящий В. В., Берченко Н. Н. О степени ионизации собственных дефектов в кристаллах $Cd_xHg_{1-x}Te$ в широком интервале температур. 3, 446
- Елигашев И. А., см. Орлов Л. К. 6, 987
- Емцев В. В., Далуда Ю. Н., Шаховцов В. И., Шиндич В. Л., Неймаш В. Б., Антошенко Р. С., Шмальц К. Кислородосодержащие термодоны, образующиеся в кремнии при «горячем» γ -облучении. 2, 374
- Емцев В. В., Клиггер П. М., Машовцев Т. В., Миразизян К. М. Влияние условий электронного облучения на скорость образования А-центров в n -кремнии. 7, 1209
- Епифанов М. С., Шипилин А. В., Шленский В. Н. Эффект заирания электронов в фотопреобразователях при высокой интенсивности освещения. 8, 1359
- Еремин В. К., см. Андреев В. М. 3, 585
- Ермаков М. Г., см. Полянов В. И. 11, 2017

- Ермакова О. Н., см. Поляков В. П. 11, 2017
- Ермолаев О. Н., см. Доброго В. П. 3, 555
- Ермолин А. В., Кучма А. Е., Свердлов В. А. Поверхностные плазменные волны в сверхрешетках с квантовыми ямами. 12, 2197
- Ершов М. Ю., Захарова А. А., Рыжий В. И. К теории переноса горячих электронов в гетероструктурных транзисторах. 7, 1265
- Ефанов А. В. Шоттковское экранирование заряженной дислокационной стенки в полупроводнике. 5, 902
- Ефимов А. Д., см. Авакянц А. П. 4, 193
- Ефимова Б. А., см. Коржуев М. А. 5, 805
- Жадько П. П., см. Гузь В. Н. 3, 409
- Жарких Ю. С., Тычкина С. В. УФ стимулированные изменения зарядового состояния свободной поверхности системы Si—SiO₂. 11, 2062
- Ждан А. Г., см. Гольдман Е. И. 1, 159
- Ждан А. Г., см. Гольдман Е. И. 3, 503
- Жевно А. Н., см. Босак В. И. 3, 570
- Железняк В. Б., см. Грибников З. С. 3, 401
- Жиляев Ю. В., Криволапчук В. В., Назаров Н., Никитина И. П., Полетаев Н. К., Сергеев Д. В., Травников В. В., Федоров Л. М. Низкотемпературная фотолюминесценция эпитаксиальных пленок фосфида галлия, выращенных на кремниевых подложках. 7, 1303
- Жиляев Ю. В., см. Акимов А. В. 4, 82
- Житинская М. К., Карпов А. А., Немов С. А. Примесные состояния галлия в Pb_{1-x}Se_xTe. 9, 1589
- Житинская М. К., Колодка С. В., Немов С. А. Явления переноса в p-PbTe(Ag, Na). 2, 292
- Житинская М. К., Немов С. А., Прошин В. Н. Глубокая самокомпенсация в системе PbSe(Cl, Se₁₀₀). 6, 1116
- Жукаускас А., см. Балтракеюнас Р. 9, 1550
- Жукова Т. Б., см. Алексеева Г. Т. 12, 2155
- Жуковский П. В., Канторов С. Б., Кищак К., Мончка Д., Стельмах В. Ф. Аморфизация кремния при имплантации ионов Ag⁺ в интервале температур 150—400 К. 8, 1475
- Жуковский П. В., Канторов С. Б., Стельмах В. Ф., Тадеуш Н. Н., Шилагарди Г. Накопленные дивакансии в кремнии при длительном облучении нейтронами. 8, 1473
- Журавлев К. С., Морозов Б. В., Терехов А. С., Якушева Н. А. Механизмы снижения эффективности излучательной рекомбинации сильно легированного эпитаксиального p-GaAs: Ge. 4, 702
- Журавлев К. С., Чикичев С. И., Штаске Р., Якушева Н. А. Исследование комплексообразования в эпитаксиальном сильно легированном p-GaAs: Ge методом фотолюминесценции. 9, 1645
- Журавлев К. С., Якушева Н. А. Влияние состава Ga_{1-x}Bi_x жидкой фазы на образование комплексов в эпитаксиальном GaAs, сильно легированном германием. 5, 829
- Журавлева В. В., см. Алфёров Ж. И. 2, 361
- Заболотский С. Е., см. Бузынин А. Н. 2, 264
- Заец А. И., см. Голюкова О. А. 4, 768
- Зайко Ю. П. Усредненное описание нелинейных волн плотности неравновесных носителей в полупроводниках. 8, 1478
- Зайковский А. В., см. Гицу Д. В. 2, 382
- Зайцев Б. А., см. Герасименко Н. Н. 2, 391
- Засавицкий И. П., см. Валеико М. В. 8, 1437
- Заставный Ю. В., см. Богданов Е. В. 3, 565
- Захаренков Л. Ф., см. Мастеров В. Ф. 4, 610
- Захаренков Л. Ф., см. Штельмах К. Ф. 8, 1482
- Захарова А. А., см. Ершов М. Ю. 7, 1265
- Заячук Д. М., см. Гарасим В. И. 3, 533
- Заячук Д. М., см. Гарасим В. И. 12, 2102
- Зверева М. Л., см. Аронзон Б. А. 4, 687
- Звонков Б. Н., см. Алешкин В. Я. 5, 892
- Звонков Б. Н., см. Карпович И. А. 12, 2172
- Звягин И. П., Курова И. А., Мелешко Н. В., Ормонт Н. Н. О механизмах образования фотониндуцированных дефектов в нелегированных пленках α-Si: H. 10, 1726
- Звягин И. П., Курова И. А., Мелешко Н. В., Ормонт Н. Н. Насыщение фотопроводимости и особенности аннигиляции фотостимулированных дефектов в нелегированных пленках α-Si: H. 11, 1992
- Зебрев Г. И. Эффективная подвижность при рассеянии на шероховатостях границы раздела в инверсионном слое. 5, 908
- Зебрев Г. И., Усейнов Р. Г. Простая модель вольт-амперных характеристик МДП транзистора. 5, 777
- Зебрев Г. И., см. Усейнов Р. Г. 4, 752
- Земко А. Е., см. Гаубас Э. 4, 773
- Зимогорова Н. С., см. Андреев В. М. 7, 1194
- Золотарев М. Л., см. Басалаев Ю. М. 5, 916
- Зув В. В., см. Гончарова А. Г. 4, 660
- Зув В. В., см. Григорьев В. В. 11, 2031
- Зюганов А. Н., см. Гусев М. Ю. 8, 1413
- Ибрагимова М. И., см. Барышев Н. С. 2, 209
- Ибрагимова М. И., см. Барышев Н. С. 2, 363

- Иванов В. Г., см. Агранов Г. А. 3, 438
- Иванов И. С., см. Супрунчик В. В. 6, 1014
- Иванов С. В., см. Алфёров Ж. И. 1, 152
- Иванов С. В., см. Алфёров Ж. И. 1, 201
- Иванов С. В., см. Алфёров Ж. И. 2, 359
- Иванов С. В., см. Алфёров Ж. И. 2, 361
- Иванов С. В., см. Копьев П. С. 4, 717
- Иванова Г. Н., см. Болбошенко В. З. 11, 1929
- Иванов-Омский В. И., Миронов К. Е., Мынбаев К. Д. Электрофизические свойства $Cd_xHg_{1-x}Te$, подвергнутого ионно-лучевому травлению. 12, 2222
- Иванов-Омский В. И., см. Баженов Н. Л. 1, 93
- Иванов-Омский В. И., см. Васильев В. П. 1, 196
- Иванов-Омский В. И., см. Георгиц Е. И. 10, 1732
- Иванов-Омский В. И., см. Георгиц Е. И. 10, 1823
- Иванов-Омский В. И., см. Георгиц Е. И. 12, 2160
- Иванов-Омский В. И., см. Мпронов К. Е. 3, 582
- Иванюкович В. А., Карась В. И., Ломако В. М. Низкотемпературное облучение арсенида галлия. 1, 185
- Иванюкович В. А., Карась В. И., Ломако В. М. Структура пииков E_4 и E_5 в $n-GaAs$. 8, 1427
- Иванюкович В. А., Карась В. И., Ломако В. М., Счастный В. В., Тарасевич А. Д. Отжиг радиационных дефектов EMI и $E10$ в $GaAs$. 11, 2051
- Иванютин Л. А., см. Быковский В. А. 1, 77
- Иващенко А. И., Копанская Ф. Я., Тарченко В. П. ИК люминесценция в полупроводнике с дюрочным фосфиде галлия, обусловленная P_{Ga} . 6, 1001
- Иващенко В. М., см. Вагидов Н. З. 6, 1087
- Ивченко В. Л., см. Абдукадыров А. Г. 1, 136
- Ивченко Е. Л., см. Абдукадыров А. Г. 5, 844
- Игнатьева Л. А., см. Монозон Б. С. 11, 1987
- Ижин А. И., см. Баженов Н. Л. 1, 93
- Израэльянц К. Р., см. Мусатов А. Л. 9, 1523
- Илащук М. И., см. Бабий П. И. 8, 1444
- Ильин М. А., Карасев П. Ю., Мильвидский М. Г., Михайлова Н. Г., Пшеничная А. Н. Оптические свойства эпитаксиальных гетероструктур $AlGaAsSb/GaSb$ в инфракрасной области спектра. 5, 800
- Ильичев Э. А., Олейник С. П., Матына Л. И., Варламов И. В., Лишиц Т. Л., Инкин В. Н. Гетеропереход $n-GaAs-ZnS$ в МДП приборах. I. Электрофизические свойства гетероперехода. 5, 788
- Ильичев Э. А., Олейник С. П., Матына Л. И., Варламов И. В., Лишиц Т. Л., Инкин В. Н. Гетеропереход $n-GaAs-ZnS$ в МДП приборах. II. Транзисторы с изолированным затвором. 6, 978
- Ильичев Э. А., см. Гергель В. А. 12, 2411
- Ильченко Л. Г., Огенько В. М. Кулоновское взаимодействие зарядов вблизи двумерных слоев. 3, 576
- Имамов Э. З., см. Дмитриев А. П. 12, 2493
- Именков А. Н., см. Андаснава А. А. 10, 1708
- Инкин В. Н., см. Ильичев Э. А. 5, 788
- Инкин В. Н., см. Ильичев Э. А. 6, 978
- Иноземцев С. А., см. Дубровский Ю. В. 5, 928
- Ирха В. И., см. Курмашев Ш. Д. 3, 558
- Исмаилов Т. Г., см. Гашимаде Ф. М. 4, 673
- Истратов А. А., см. Вывонко О. Ф. 9, 1650
- Итальянцев А. Г., см. Омеляновская Н. М. 11, 2040
- Каган В. Д. Ударная ионизация, производимая электронами, движущимися в неоднородном электрическом поле. 3, 568
- Кадушкин В. И. Влияние температуры на столкновительное уширение уровней Ландау. 11, 2029
- Кадушкин В. И., Сеничкин А. П. Энергетическая и импульсная релаксация $2D$ -электронов в квантовом магнитном поле. 6, 1109
- Кадушкин В. И., Сеничкин А. П. Анизотропия квантовых осцилляций магнитосопротивления и проводимости гетероструктур с $2D$ -электронами. 6, 1111
- Кадушкин В. И., Сеничкин А. П. Анизотропия квантовых осцилляций магнитосопротивления и проводимости гетероструктур с $2D$ -электронами на сильно разориентированных подложках. 12, 2080
- Кадушкин В. И., Сеничкин А. П., Фомичев С. И. Фотомагнитный эффект в системе $n-Al_xGa_{1-x}As/GaAs$ с $2D$ -электронами. 7, 1279
- Казакевич Л. А., Кузнецов В. И., Лугаков П. Ф., Филипов И. М., Цикунов А. В. Влияние деформационных напряжений границы раздела $Si-SiO_2$ на образование и отжиг радиационных дефектов в кремнии. 3, 517
- Казанин М. М., см. Голикова О. А. 4, 768
- Казанин М. М., см. Голикова О. А. 7, 1190
- Казанский А. Г. Температурная зависимость положения уровня Ферми в аморфном гидрированном кремнии n -типа. 3, 556
- Казанский А. Г. Эффект Стеблера—Вронского в аморфном гидрированном кремнии, легированном фосфором. 8, 1462
- Казанский А. Г., Климашин И. В., Кузнецов С. В. Особенности температурной зависимости фотопроводимости слабо легированного бором $a-Si$: Н. 9, 1628

- Казанский А. Г., Миличевич Е. П., Уразбаева Р. А. Температурное гашение фотопроводимости в аморфном гидрированном кремнии, слабо легированном бором. 6, 1143
- Казанцев А. Б., см. Андреев В. М. 10, 1757
- Кайданов В. И., Рыков С. А., Рыкова М. А., Сюрис О. В. Исследование метастабильных квазилокальных состояний индия в теллуриде свинца методом туннельной спектроскопии. 4, 144
- Калиновский В. С., см. Брунок П. Н. 7, 1320
- Калинушкин В. П., см. Бузынин А. Н. 2, 264
- Калмыкова И., см. Болбошенко В. З. 11, 1929
- Калугин Н. Г., см. Гавриленко В. И. 5, 825
- Кальфа А. А., Пашковский А. Б. Пространственный перенос двумерных электронов в структуре металл— $Al_xGa_{1-x}As$ —GaAs с селективным легированием. 3, 521
- Кальфа А. А., Пашковский А. Б. Пространственный перенос электронов в полевых транзисторах на гетероструктурах с селективным легированием. 7, 1187
- Камаев Г. Н., см. Ахметов В. Д. 1, 72
- Камаев Г. Н., см. Болотов В. В. 10, 1697
- Каничев М. Р., см. Бордовский Г. А. 3, 527
- Канищева Н. А., см. Викулин И. М. 11, 1959
- Канторов С. Б., см. Жуковский П. В. 8, 1473
- Канторов С. Б., см. Жуковский П. В. 8, 1475
- Канцлерис Ж., см. Дедулевич С. 3, 427
- Канчуковский О. П., см. Фастыковский П. П. 2, 310
- Канява А., см. Гаубас Э. 4, 773
- Каплан Б. И., см. Владимирова В. В. 8, 1449
- Каплан Б. И., см. Владимирова В. В. 11, 1995
- Капустин Ю. А., Колокольников Б. М., Котов В. В., Медведков А. В. Поведение центров золота в кремнии n -типа после нейтронного и γ -облучения и механической обработки поверхности. 5, 871
- Капустин Ю. А., Колокольников Б. М., Свешников А. А. Фотостимулированная диффузия золота в кремнии при импульсной фотонной обработке. 2, 318
- Капустин Ю. А., см. Глебов С. С. 9, 1689
- Капустин Ю. А., см. Постников В. С. 5, 855
- Карабаев А. Г., см. Торчинская Т. В. 8, 1337
- Карабаев В. В., Кузнецов Н. В., Филатов В. Н. Простая модель накопления радиационных дефектов в кремнии n -типа, облученном пучками водорода и гелия. 7, 1234
- Каранович А. А., Двуреченский А. В., Тыщенко И. Е., Качурин Г. А. Центры спин-зависимой рекомбинации в структурах, формируемых имплантацией ионов азота в Si. 6, 1101
- Карасев П. Ю., см. Ильин М. А. 5, 800
- Карась В. И., см. Иванюкович В. А. 4, 185
- Карась В. И., см. Иванюкович В. А. 8, 1427
- Карась В. И., см. Иванюкович В. А. 11, 2051
- Каржавин Р. В., см. Белоусов М. В. 12, 2177
- Карпов А. А., см. Житинская М. К. 9, 1589
- Карпович И. А., Алешкин В. Я., Аншон А. В., Бабушкин А. Т. С., Званков Б. Н., Малкина И. Г. Фотоэлектрические свойства эпитаксиальных гетероструктур GaAs/InGaAs с квантовой ямой. 12, 2172
- Карпович Л. М., см. Акулович Н. И. 3, 472
- Карумидзе Г. С. Влияние температуры облучения нейтронами на формирование дефектов структуры в кремнии, выращенном методом Чохральского. 11, 1973
- Карягин В. В., Ляпилин И. И. Резонансный захват носителей в спиновые квантовые ямы в магнитном поле. 2, 323
- Каряев В. Н., см. Бирюлин Ю. Ф. 12, 2249
- Каспьян В. А., см. Болбошенко В. З. 11, 1929
- Кахраманов С. Ш., см. Велиюлин Э. И. 11, 2060
- Качлишвили З. С., Кезерашвили И. Д. Динамический хаос в полупроводниках с горячими носителями. 6, 1106
- Качурин Г. А., см. Каранович А. А. 6, 1101
- Каширская Л. М., Рябова Л. И., Тананаева О. И., Шпрокова Н. А. Гальваномагнитные характеристики твердых растворов $PbTe<Cr>$ при изменении температуры и под давлением. 8, 1349
- Квяткевич А. И., см. Бриллиантов Н. В. 5, 860
- Кезерашвили И. Д., см. Качлишвили З. С. 6, 1106
- Кернер Б. С., Седаков А. Ю., Суханов А. Н. Теория локальной туннельной генерации носителей в p - n -переходах на основе узкозонных полупроводников. 8, 1455
- Кернер Б. С., см. Ващенко А. В. 10, 1705
- Кернер Б. С., см. Гафийчук В. В. 4, 724
- Кернер Б. С., см. Гафийчук В. В. 7, 1282
- Кикоин К. А., Курек И. Г., Мельничук С. В. Химические тенденции для глубоких $3d$ -уровней в полупроводниковых соединениях $A^{IV}V^{VI}$. 3, 587
- Кикоин К. А., см. Ванем Р. А. 10, 1827
- Ким С. Г., см. Глазов В. М. 10, 1790
- Кирдяшкпина Л. А., Кюрегян А. С., Шлыгин П. Н., Юрков С. Н. Ударная ионизация в кремнии, выращенном различными методами. 3, 560

- Кирпилов В. И., см. Постников В. С. 5, 855
- Кисин М. В. Резонансное прохождение резкой гетерограницы электроном проводимости. 3, 433
- Кисин М. В. Пограничные состояния электронного типа в инверсных гетероструктурах. 11, 1983
- Китин Д. В., см. Вавилов В. С. 12, 2132
- Китык И. В., см. Довгий Я. О. 9, 1608
- Кищак К., см. Жуковский П. В. 8, 1475
- Климашин И. В., см. Казанский А. Г. 9, 1628
- Климовская А. И., Прима Н. А. Дрейфовая неустойчивость, вызываемая перезарядкой центров на поверхности монопольного полупроводника. 12, 2094
- Клингер М. И., Шпинар Л. И., Ясковец Н. И. О локализованных возбужденных состояниях центров с отрицательной корреляционной энергией в стеклах. 10, 1869
- Клингер М. И., см. Шпинар Л. И. 7, 1153
- Клингер П. М., Фистуль В. И. Параметры компенсирующих центров в n -Si, сильно компенсированном облучением. 6, 1118
- Клингер П. М., см. Емцев В. В. 7, 1209
- Клочков А. М., см. Гольдман Е. И. 1, 159
- Клячкин Л. Е., см. Баграев Н. Т. 9, 1557
- Клячкин Л. Е., см. Баграев Н. Т. 9, 1563
- Клячкин Л. Е., см. Варданян Р. Р. 3, 485
- Ковалев Б. Б., Скипетров Е. П. Резонансная зона в сплаве $Pb_{1-x}Sn_xSe$ ($x=007$), облученном электронами. 8, 1379
- Ковалев Л. Е., см. Горя О. С. 8, 1496
- Ковалюк З. Д., см. Григорчак И. И. 2, 386
- Ковалюк З. Д., см. Гусев М. Ю. 8, 1413
- Ковалюк З. Д., см. Лашкарев Г. В. 3, 418
- Кожаметов С. К., см. Филатова Е. О. 7, 1216
- Козел В. В., см. Видулин И. М. 11, 1959
- Козлов В. А., см. Антохин А. Ю. 8, 1480
- Козловский В. В., Кольченко Т. И., Ломако В. М., Мороз С. Е. Влияние интенсивности облучения и энергии частиц на эффективность образования глубоких центров в n -InP. 6, 1123
- Козловский С. И., см. Гузь В. Н. 3, 409
- Козловский С. И., см. Дубров И. Н. 4, 763
- Козловский Ю. Я., Неустроев Л. Н., Осипов В. В. Поперечная фотопроводимость классических композиционных сверхрешеток. 3, 497
- Козуб В. И. Новые книги по полупроводникам. 5, 943; 8, 1499; 10, 1893; 12, 2225
- Колесников И. В., см. Малютенко В. К. 5, 866
- Колесников Н. В., Ломасов В. Н., Мальханов С. Е. Влияние интенсивности электронного облучения на накопление K -центров в кремнии. 2, 372
- Коллин Н. Г., Королева И. А., Марков А. В., Освенский В. Б. Влияние отклонения состава от стехиометрии на электрофизические свойства ядра легированного арсенида галлия. 1, 187
- Коллюх А. Г., Малютенко В. К., Мороженко В. А. Излучение n -InSb в далекой III области. 5, 931
- Коллюх А. Г., см. Владимиров В. В. 8, 1449
- Коллюх А. Г., см. Владимиров В. В. 11, 1995
- Колодка С. В., см. Житинская М. К. 2, 292
- Колокольников Б. М., см. Глобов С. С. 9, 1689
- Колокольников Б. М., см. Капустин Ю. А. 2, 318
- Колокольников Б. М., см. Капустин Ю. А. 5, 913
- Колчанова Н. М., см. Андаспаева А. А. 10, 1708
- Кольцов Г. И., Юрчук С. Ю., Алешин В. Д., Кунакин В. И. Образование глубоких центров в фосфиде галлия при создании ионно-имплантированных фоточувствительных структур. 5, 782
- Кольченко Т. И., Ломако В. М. Модификация центра $E3$ в облученном n -GaAs. 2, 295
- Кольченко Т. И., Ломако В. М., Мороз С. Е. Отжиг радиационных дефектов с глубокими уровнями в n -InP. 11, 1963
- Кольченко Т. И., см. Быковский В. А. 1, 77
- Кольченко Т. И., см. Быковский В. А. 12, 2117
- Кольченко Т. И., см. Козловский В. В. 6, 1123
- Коляда В. А., см. Солдатов В. С. 9, 1611
- Компренко С. М., см. Баранский П. И. 1, 121
- Компренко С. М., см. Баранский П. И. 8, 1490
- Комиссаров Г. П., см. Гертович Т. С. 1, 192
- Кондратьев Б. С., Попов И. В., Стрельчук А. М., Таранов М. Л. Электрические характеристики и температурный коэффициент напряжения пробы микроплазм в низковольтных карбид-кремниевых p - n -структурах. 4, 647
- Конников С. Г., Поссе В. А., Соловьев В. А., Уманский В. Е., Чистяков В. М. Определение электрофизических параметров полупроводников методом математического моделирования сигнала индуцированного тока. 2, 271
- Конников С. Г., Свердлов М. И., Филиппенко В. Я., Хазанов А. А. Электронно-зондовые исследования деградации непрерывных инжекционных гетеролазеров. 11, 2010
- Конников С. Г., см. Брунков П. Н. 7, 1320
- Конников С. Г., см. Брунков П. Н. 11, 1978
- Конюлева Р. Ф., см. Гуцев Г. Л. 3, 479

- К о н с т а н т и н о в О. В., Ц а р е н к о в Б. В. Изменение поверхностного потенциала полупроводника при освещении. 12, 2126
- К о н с т а н т и н о в О. В., см. Вычковский Д. Н. 10, 1848
- К о н ь к о в О. И., см. Атаев Ж. З. 488
- К о н а н с к а я Ф. Я., см. Иващенко А. И. 6, 1001
- К о п ь е в П. С., И в а н о в С. В., Л е д е н ц о в Н. Н., М е л ь ц е р Б. Я., П а д т о ч н ы й Ю. М., У с т и н о в В. М. Получение методом молекулярно-лучевой эпитаксии гетероструктур GaSb/InAs/GaSb с высокой подвижностью двумерных электронов. 4, 717
- К о п ь е в П. С., Л е д е н ц о в Н. Н. Гигантские диффузионные длины неравновесных носителей в квантово-размерных гетероструктурах. 9, 1691
- К о п ь е в П. С., М и р л и н Д. Н., П о л я к о в Д. Г., Р е ш и н а И. И., С а п е г а В. Ф., С и р е н к о А. А. Фотолуминесценция горячих двумерных электронов в квантовых ямах и определение времен полярного рассеяния. 7, 1200
- К о п ь е в П. С., см. Алфёров Ж. И. 1, 152
- К о п ь е в П. С., см. Алфёров Ж. И. 1, 201
- К о п ь е в П. С., см. Алфёров Ж. И. 2, 359
- К о п ь е в П. С., см. Алфёров Ж. И. 2, 361
- К о п ы л о в А. А., см. Васильев В. А. 9, 1675
- К о р ж у е в М. А., Б а н к и н а В. Ф., Е ф и м о в а Б. А., Ф и л и п о в и ч Н. Н. Электрофизические свойства сплавов Cu_{1-x}Se , легированных электроактивными добавками. 5, 805
- К о р л я к о в Д. Н., см. Дашевский М. Я. 12, 2073
- К о р н и л о в Б. В. Метод определения отношений сечений фотоионизации для многозарядных акцепторов в полупроводниках. 10, 1867
- К о р о в и н а Л. А., см. Громовой Ю. С. 2, 250
- К о р о л е в а И. А., см. Колин Н. Г. 1, 187
- К о р о л ь к о в В. И., см. Абдуллаев Х. О. 11, 1969
- К о р о л ь к о в В. И., см. Алфёров Ж. И. 2, 361
- К о р о с т ы ш е в с к и й Ю. М., см. Дубров И. Н. 4, 763
- К о р о т к и х В. Л., см. Мусатов А. Л. 9, 1523
- К о р о т к о в В. А., см. Горя О. С. 8, 1496
- К о р ш у н о в Ф. П., Р а д а у ц а н С. И., С о б о л е в Н. А., Т и г и в я н у И. М., К у д р я в ц е в а Е. А., У р с у В. А., Ц ы п л е н к о в И. Н., Л а м м В. Н., Ш е р а у х о в В. А. Влияние облучения быстрыми электронами на краевую фотолуминесценцию эпитаксиальных слоев $n\text{-InP}$. 11, 2034
- К о т е л ь н и к о в Е. Ю., см. Брунков П. Н. 11, 1978
- К о т е л ь н и к о в И. Н., см. Варванни Н. А. 4, 635
- К о т о в В. В., см. Капустин Ю. А. 5, 913
- К о т о в Е. В., см. Александров П. А. 6, 1132
- К о ш е л е н к о В. П., см. Крохмаль А. П. 4, 669
- К р а й ч и н с к и й А. Н., О с т а ш к о Н. И., Р о г о у ц к и й И. С. О температурной зависимости эффективности образования радиационных дефектов в кремнии и германии. 8, 1487
- К р а с п ь л ь н и к З. Ф., см. Гавриленко В. И. 5, 825
- К р а с п ь с к а я А. Г., см. Ашкинадзе Б. М. 3, 572
- К р а с п ь с к а я А. Г., см. Ашкинадзе Б. М. 5, 883
- К р а с п ь к о в а М. В., М о й ж е с с Б. Я. Биполяроны и преобразование солнечной энергии. 11, 1934
- К р а с н о б а е в Л. Я., см. Омеляновская Н. М. 11, 2040
- К р е щ у к А. М., Л а у р с Е. П., Н о в и к о в С. В., С а в е л ь е в И. Г., С е м а ш к о Е. М., С т о в п о в о й М. А., Ш и к А. Я. Инвертированная гетероструктура $\text{InP/In}_{0.53}\text{Ga}_{0.47}\text{As}$ для полевого транзистора. 6, 1145
- К р е щ у к А. М., см. Берт Н. А. 4, 653
- К р е щ у к А. М., см. Бирюлин Ю. Ф. 12, 2219
- К р е щ у к А. М., см. Воробьева В. В. 6, 1026
- К р и в е н ь С. И., см. Беляев А. Е. 11, 1999
- К р и в о л а п ч у к В. В., см. Акимов А. В. 1, 82
- К р и в о л а п ч у к В. В., см. Жилыев Ю. В. 7, 1303
- К р и т с к а я Т. В., Х и р у н е н к о Л. И., Ш а х о в ц о в В. И., Я ш н и к В. И. Особенности спектров ИК поглощения термодоноров в кристаллах Si:Ge . 6, 1129
- К р о п м а н Д. И., см. Лукьянчикова Н. Б. 9, 1659
- К р о п о т о в Г. И., см. Васильев В. П. 1, 196
- К р о х м а л ь А. П., К о ш е л е н к о В. П. Влияние эффектов легирования на экситоны, связанные с нейтральными донорами, в $6H\text{-SiC}$. 4, 669
- К р у с т о к Ю. И., Л ы о А. Э., П и й б е Т. Э. О природе 0.8 эВ полосы фотолуминесценции в легированном теллуриде кадмия. 10, 1888
- К р у т о г о л о в Ю. К., Б а р к о в а Т. Б., Д и о р д и е в С. А., К р у т о г о л о в а Л. И., Л е б е д е в а Л. В. Влияние разупорядоченности на фотолуминесценцию твердых растворов $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{P}:\text{Te}$ «переходного» диапазона составов. 9, 1673
- К р у т о г о л о в а Л. И., см. Крутоголов Ю. К. 9, 1673
- К р ы л о в Д. Г., Л а д ы г и н Е. А. Методика оценки заряда подзатворного диэлектрика в структурах металл-полупроводник. 5, 936
- К р ы л о в Д. Г., Л а д ы г и н Е. А., Г о р ю н о в Н. Н. Кинетика накопления и отжига поверхностных состояний на границе раздела структур кремний-оксид кремния при облучении. 6, 997
- К р ы л о в а И. В., см. Вяткин А. П. 1, 109
- К р ы к о в а И. В., см. Балтрамеюнас Р. 9, 1550
- К р ы ч к о в С. В. Резонансное взаимодействие ультразвука с электронами сверх-

решетки в кваптующем магнитном поле. 11, 2054

Крючков С. В. Влияние примесей на высокочастотную проводимость сверхрешетки. 12, 2200

Крючков С. В., Сыродоев Г. А. Ионизация примесей бризерами в сверхрешетке. 5, 913

Крючков С. В., Сыродоев Г. А. Затухание бризера в сверхрешетке. 6, 1120

Кудинов В. А., Пека Г. П., Смольяра А. Н. Спектральные характеристики длинных фотодиодов с нелинейным профилем ширины запрещенной зоны. 10, 1736

Кудрявцева Е. А., см. Коршунов Ф. П. 11, 2034

Кудыкина Т. А., см. Григорьев Н. Н. 1, 190

Кузнецов В. И., см. Казакевич Л. А. 3, 517

Кузнецов Н. В., см. Караваев В. В. 7, 1234

Кузнецов Н. И., см. Аникин М. М. 8, 1384

Кузнецов С. В., см. Казанский А. Г. 9, 1628

Кулаев Г. И., см. Дерябина Т. И. 7, 1182

Кулиев Б. И., см. Аскеров Б. М. 12, 2211

Куликов Г. С., см. Аблова М. С. 11, 1943

Кулиш Н. Р., Лисица М. П., Малыш Н. И., Булах Б. М. Нелинейность краевого поглощения CdSe. 1, 25

Кулиш Н. Р., см. Булах Б. М. 2, 254

Кульбачинский В. А., см. Азов С. А. 2, 283

Кульбачинский В. А., см. Чуднов С. М. 11, 1905

Кунакин В. И., см. Кольцов Г. И. 5, 782

Кунец В. П., см. Булах Б. М. 2, 254

Курек И. Г., см. Кикоин К. А. 3, 587

Курмашев Ш. Д., Ирха В. И., Викулин И. М. Спектр фоточувствительности инжекционных фотодиодов с варизонной базой в магнитном поле. 3, 558

Курова И. А., Мочалова Д. А. Метастабильные состояния в пленках α -Si:H, легированных бором. 2, 314

Курова И. А., см. Звягин И. П. 10, 1726

Курова И. А., см. Звягин И. П. 11, 1992

Курьшев Г. Л., см. Герасименко Н. Н. 7, 1245

Кучеров И. Я., см. Булах Г. И. 5, 926

Кучинский П. В., см. Баранов И. А. 4, 731

Кучма А. Е., см. Ермолин А. В. 12, 2197

Кюрегян А. С. Влияние крупномасштабных флуктуаций распределения примесей на туннелирование и электропоглощение в обратно смещенных p - n -переходах. 7, 1162

Кюрегян А. С., см. Кирдяшкина Л. А. 3, 560

Кязым-заде А. Г., Ахмедов А. А., Гасанова Ф. А., Султанова А. Г. Полевое гашение экспоненциальной фотопроводимости в монокристаллах InSe. 10, 1873

Лавдовский К. Г., см. Аладашвили Д. И. 2, 234

Лагвилава Т. А., Мильвидский М. Г., Соловьева Е. В. Влияние Urb на остаточные донорные и акцепторные примеси в GaP. 8, 1357

Лагвилава Т. А., см. Джамагидзе Ш. З. 9, 1670

Лагунова Т. С., см. Баранов А. И. 1, 98

Лагунова Т. С., см. Баранов А. И. 6, 1072

Ладыгин Е. А., см. Дашевский М. Я. 12, 2073

Ладыгин Е. А., см. Крылов Д. Г. 5, 936

Ладыгин Е. А., см. Крылов Д. Г. 6, 997

Лазарева О. И., см. Соколина Г. А. 1, 175

Лазоренко В. И., см. Гусев М. Ю. 8, 1413

Лазоренко В. И., см. Лашкарев Г. В. 3, 418

Ламм В. Н., см. Коршунов Ф. П. 11, 2034

Лантратов В. М., см. Андреев В. М. 7, 1194

Лалин В. Г., см. Дубровский Ю. В. 5, 928

Ларионова В. А., см. Германенко А. В. 10, 1762

Ларкин И. А., см. Дубровский Ю. В. 5, 928

Лаурс Е. П., см. Крещук А. М. 6, 1145

Лашкарев Г. В., Радченко М. В., Лазоренко В. И., Ковалюк З. Д. Особенности термоэлектрических и электрических свойств слоистого полупроводника InSe при низких температурах. 3, 418

Лашкарев Г. В., см. Бродовой А. В. 9, 1684

Лашкарев Г. В., см. Гусев М. Ю. 8, 1413

Лебедев А. А., см. Аникин М. М. 8, 1384

Лебедев А. А., см. Астрова Е. В. 3, 549

Лебедев А. А., см. Витман Р. Ф. 1, 45

Лебедева Л. В., см. Крутоголов Ю. К. 9, 1673

Левандовский В. Г., см. Вавилов В. С. 2, 379

Левин А. А., см. Хакимов З. М. 1, 29

Левин В. И., см. Андреев А. П. 5, 821

Левин Е. И., см. Аладашвили Д. И. 2, 234

Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. Влияние деструктивного одноосного сжатия на шум $1/f$ в GaAs. 10, 1807

Левинштейн М. В., см. Гук Е. Г. 5, 813

Левинштейн М. Е., см. Дьяконова Н. В. 5, 836

Левинштейн М. Е., см. Дьяконова Н. В. 9, 1531

Леденцов Н. Н., см. Алфёров Ж. И. 1, 152

Леденцов Н. Н., см. Алфёров Ж. И. 1, 201

- Леденцов Н. Н., см. Алфёров Ж. И. 2, 359
- Леденцов Н. Н., см. Алфёров Ж. И. 2, 361
- Леденцов Н. Н., см. Кошьев П. С. 4, 717
- Леденцов Н. Н., см. Кошьев П. С. 9, 1691
- Леринман Н. К., см. Глузман Н. Г. 10, 1766
- Либенсон В. Н., Нормурадов М. Т., Рысбаев А. С. Особенности возбуждения плазмонов в полупроводниковом подуровне. 1, 166
- Либерис Ю., см. Анмонтас С. 12, 2214
- Лишица Т. Л., см. Ильичев Э. А. 5, 788
- Лишица Т. Л., см. Ильичев Э. А. 6, 978
- Лисица М. П., см. Булах Б. М. 2, 254
- Лисица М. П., см. Кулиш Н. Р. 1, 25
- Лисунов К. Г., см. Арушанов Э. К. 7, 1179
- Литвак А. М., Чарыков Н. А. Термодинамический расчет зависимости ширины запрещенной зоны от состава многокомпонентных твердых растворов на основе соединений A_3B_5V . 12, 2106
- Литвак-Горская Л. Б., см. Банная В. Ф. 12, 2145
- Литвак-Горская Л. Б., см. Гальперин Ю. М. 1, 3
- Литвиненко С. В., см. Скрышевский В. А. 10, 1886
- Литвинов В. В., Пальчик Г. В., Урнегов В. И. О влиянии радиационных дефектов на кинетику образования термодоноров в кремнии. 2, 376
- Литовченко Н. М., см. Глинчук К. Д. 9, 1685
- Ловейко В. Н., см. Добровольский В. Н. 6, 1067
- Логвинов Г. Н., см. Гуревич Ю. Г. 10, 1715
- Ломако В. М., см. Барацов И. А. 4, 731
- Ломако В. М., см. Быковский В. А. 1, 77
- Ломако В. М., см. Быковский В. А. 12, 2117
- Ломако В. М., см. Иванюкович В. А. 1, 185
- Ломако В. М., см. Иванюкович В. А. 8, 1427
- Ломако В. М., см. Иванюкович В. А. 11, 2051
- Ломако В. М., см. Козловский В. В. 6, 1123
- Ломако В. М., см. Кольченко Т. И. 2, 295
- Ломако В. М., см. Кольченко Т. И. 11, 1963
- Ломасов В. Н., см. Берман Л. С. 7, 1213
- Ломасов В. Н., см. Берман Л. С. 10, 1816
- Ломасов В. Н., см. Берман Л. С. 10, 1841
- Ломасов В. Н., см. Берман Л. С. 12, 2186
- Ломасов В. Н., см. Колесников Н. В. 2, 372
- Лотоцкая С. В., см. Паранчич С. Ю. 2, 225
- Лубышев Д. И., Мигаль В. П., Преображенский В. В., Се-
 мягин В. Р., Степин С. И., Чалдышев В. В., Шарцев Ю. В. О механизме воздействия изовалентной примеси In на свойства и ансамбль дефектов GaAs, выражаемого методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 10, 1862
- Лубышев Д. И., см. Альперович В. Л. 3, 451
- Лугаков П. Ф., Лукьяница В. В. Радиационно-стимулированное образование термодоноров в зонном n -Si. 10, 1721
- Лугаков П. Ф., см. Казакевич Л. А. 3, 517
- Лукьяница В. В., см. Лугаков П. Ф. 10, 1721
- Лукьянов А. Е., см. Бузынин А. Н. 2, 264
- Лукьянченко А. И., см. Гергель В. А. 12, 2111
- Лукьянчикова Н. Б., Гарбар Н. П., Петричук М. В., Кропман Д. И. Исследование механизмов формирования $1/f$ -шума в p - n -переходах. 9, 1659
- Лупал М. В., Лютович К. Л., Панов М. Ф., Пихтин А. Н., Попов В. А. Параметры зонной структуры твердых растворов Si_xGe_{1-x} . 9, 1604
- Луценко М. Э., см. Алфёров Ж. И. 1, 152
- Луценко М. Э., см. Алфёров Ж. И. 1, 201
- Львин В. Э., см. Радауцан С. И. 9, 1592
- Львин В. Э., см. Сырбу Н. Н. 11, 1911
- Львова Т. В., см. Берковиц В. Л. 2, 353
- Львова Т. В., см. Берковиц В. Л. 6, 1031
- Львова Т. В., см. Гольдберг Ю. А. 10, 1835
- Льво А. Э., см. Крусток Ю. И. 10, 1888
- Лыук П. А., см. Вирро А. Л. 7, 1158
- Лыбченко А. В., Мысливец К. А., Олих Я. М. Рекомбинация носителей через акцепторные уровни собственных дефектов в кристаллах n - $Cd_xHg_{1-x}Te$, подвергнутых ультразвуковой обработке. 1, 171
- Любченко А. В., см. Григорьев Н. Н. 1, 190
- Лютович К. Л., см. Васильев В. А. 9, 1675
- Лютович К. Л., см. Лупал М. В. 9, 1604
- Ляпилин И. И., см. Карягин В. В. 2, 323
- Мазей Т. Ф., Цэндин К. Д. О механизме легирования халькогенидных стеклообразных полупроводников. 11, 1953
- Мазур Ю. И., см. Беляев А. Е. 11, 1999
- Макарова Т. Л., см. Воробьева В. В. 6, 1026
- Макогоненко В. Н., см. Паранчич С. Ю. 2, 225
- Максимова Н. К., см. Вяткин А. П. 1, 109
- Максимова О. Г., см. Аверкиев Н. С. 9, 1632
- Малахов Б. А., см. Дубровский Ю. В. 5, 928
- Малик А. И., Гречко В. А.,

- Грушка Г. Г. Особенности токопереноса в ПДП структурах со сквозными проводящими каналами в диэлектрике. 12, 2191
- Маликова Л. В., см. Горя О. С. 8, 1496
- Малкина И. Г., см. Алешкин В. Я. 5, 892
- Малкина И. Г., см. Карпович И. А. 12, 2172
- Мальнев В. Н., см. Вавилов С. Е. 2, 379
- Мальханов С. Е., см. Колесников Н. В. 2, 372
- Малыш Н. И., см. Булах Б. М. 2, 254
- Малыш Н. И., см. Кулиш Н. Р. 1, 25
- Малютенко В. К., Гуга К. Ю., Рыбак А. М. Люминесценция i -Ge в условиях одноосного сжатия. 8, 1467
- Малютенко В. К., Пипа В. И., Яблоновский Е. Н., Колесников И. В. Спектр отрицательной люминесценции в InSb. 5, 866
- Малютенко В. К., см. Акопян А. А. 8, 1424
- Малютенко В. К., см. Болгов С. С. 9, 1598
- Малютенко В. К., см. Болгов С. С. 9, 1677
- Малютенко В. К., см. Владимиров В. В. 8, 1449
- Малютенко В. К., см. Владимиров В. В. 11, 1995
- Малютенко В. К., см. Колых А. Г. 5, 931
- Малютенко В. К., см. Пипа В. И. 7, 1175
- Маляренко А. М., см. Баграев Н. Т. 9, 1557
- Маляренко А. М., см. Баграев Н. Т. 9, 1563
- Манассон В. А., см. Гертович Т. С. 1, 192
- Манчини Дж., см. Чудинов С. М. 11, 1905
- Маньковская И. Г., см. Довгий Я. О. 9, 1608
- Маргарян А. Л., см. Арутюнян В. М. 1, 203
- Маринченко А. В., Хируненко Л. И., Шаховцов В. И., Яшник В. И. Структура полос поглощения термодонорных центров в кремнии. 6, 1126
- Маркин Ю. В., см. Гольдман Е. И. 1, 159
- Марков А. В., Омеляновский Э. М., Освенский В. Б., Поляков А. Я., Тишкин М. В. Глубокие центры в монокристаллах GaAs, выращенных методом Чохральского с добавлением кислорода. 3, 507
- Марков А. В., см. Колин Н. Г. 1, 187
- Мартупас З., см. Денис В. 4, 720
- Мартынов В. Н., см. Горн И. А. 3, 538
- Марчук И. З., см. Григорчак И. И. 2, 386
- Масленников Н. М. К вопросу о величине коэффициента понижения в кремнии. 7, 1325
- Маслюк В. Т. Устойчивые состояния и структурные превращения в аморфном гидрированном кремнии. 7, 1332
- Мастейка Р., см. Вайткус Ю. 11, 1919
- Мастеров В. Ф., Захаренков Л. Ф. Редкоземельные элементы в полупроводниках $A^{III}B^V$ (обзор). 4, 610
- Мастеров В. Ф., см. Георгиадзе Е. И. 12, 2160
- Матвиив М. В., см. Яфясов А. М. 5, 875
- Матына Л. И., см. Ильичев Э. А. 5, 788
- Матына Л. И., см. Ильичев Э. А. 6, 978
- Махмудов А. Ш., см. Хакимов З. М. 1, 29
- Мацонашвили Б. П., см. Валейко М. В. 8, 1437
- Машкевич О. Л., см. Глозштейн Ю. М. 3, 544
- Машкевич О. Л., см. Гуревич Ю. Г. 7, 1327
- Машовец Д. В., см. Хасбулатов А. М. 6, 1136
- Машовец Т. В., см. Витман Р. Ф. 1, 45
- Машовец Т. В., см. Емцев В. В. 7, 1209
- Медведев Б. К., см. Варванян Н. А. 4, 635
- Медведев Б. К., см. Поляков В. И. 11, 2017
- Медведев Б. К., см. Чудинов С. М. 11, 1905
- Медведкин Г. А., Рудь Ю. В., Таиров М. А. Анизотропия краевого оптического поглощения компенсированных кристаллов n -CdGeP₂. 7, 1306
- Медведков А. В., см. Канустин Ю. А. 5, 913
- Мездригина М. М., см. Голикова О. А. 7, 1190
- Мезрин О. А., Трошков С. К., Шпик А. Я. Двумерный электронный газ в изотипном гетеропереходе. 4, 638
- Мезрин О. А., см. Гольдберг Ю. А. 10, 1835
- Мелешко Н. В., см. Звягин И. П. 10, 1726
- Мелешко Н. В., см. Звягин И. П. 11, 1992
- Меликсетян В. А., см. Арутюнян В. А. 1, 203
- Мельник Н. Н., см. Околечников А. П. 4, 747
- Мельникова Ю. С. О понижении порога неустойчивости однородного лавинного пробоя кремниевых p^+n -переходов. 1, 66
- Мельничук С. В., см. Кипкоян К. А. 3, 587
- Мельцер Б. Я., см. Алфёров Ж. И. 1, 152
- Мельцер Б. Я., см. Алфёров Ж. И. 1, 201
- Мельцер Б. Я., см. Алфёров Ж. И. 2, 359
- Мельцер Б. Я., см. Алфёров Ж. И. 2, 361
- Мельцер Б. Я., см. Копьев П. С. 4, 717
- Мессерер М. А., см. Ванем Р. А. 10, 1827
- Мехтиев М. М., см. Григорьев В. В. 11, 2031
- Мехтиев Н. М. Фотополюхромизм легированных кристаллов GaSe. 9, 1505
- Мигаль В. П., см. Альперович В. Л. 3, 451
- Мигаль В. П., см. Лубышев Д. И. 10, 1862
- Милчевич Е. П., см. Казанский А. Г. 6, 1143
- Мильвидский М. Г., см. Ильич М. А. 5, 800

- Мильвидский М. Г., см. Лагвилава Т. А. 8, 1367
- Минаян Г. Р., см. Аветисян С. К. 4, 766
- Минаян Г. Р., см. Аветисян С. К. 8, 1421
- Миптанров А. М., Смекалкин К. Е., Устинов В. М., Хвостиков В. П. Комбинационное рассеяние света на смешанных LO-фонон-плазменных колебаниях в двумодовых твердых растворах $n\text{-Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($x > 0.4$). 9, 1539
- Миразиян К. М., см. Емцев В. В. 7, 1209
- Мирнашвили Ш. М., Туманишвили Э. П., Чиковани Н. И., Хавтаси Л. Г. Исследование фотопроводимости в высокоомном $p\text{-InSb}$. 3, 574
- Мирлин Д. И., см. Копьев П. С. 7, 1200
- Миронов К. Е., Мынбаев К. Д., Иванов-Омский В. И. Диффузия индия в эпитаксиальных слоях $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}$. Те. 3. 582
- Миронов К. Е., см. Иванов-Омский В. И. 12, 2222
- Миронова Г. А., см. Азоу С. А. 2, 283
- Михайлова М. П., см. Афраплов М. А. 8, 1397
- Михайлова Н. Г., см. Ильин М. А. 5, 800
- Михнович В. В., Фирсов Т. В. Модель кинетики формирования радиационных дефектов в кремниевых диодных структурах. 4, 181
- Мнацаканов Т. Т., см. Грессеров Б. Н. 9, 1668
- Мовилэ В. Ф., см. Георгицэ Е. И. 10, 1823
- Монн М. Д., см. Дубров Н. Н. 4, 763
- Мойжес Б. Я., см. Красинькова М. В. 11, 1934
- Мокеров В. Г., см. Варванни Н. А. 4, 635
- Мокеров В. Г., см. Поляков В. И. 11, 2047
- Мокина И. А., см. Белоусов М. В. 12, 2177
- Мокина И. А., см. Дерингас А. 12, 2167
- Молоцкий М. И., см. Гольдфарб М. В. 7, 1330
- Молоцкий М. И., см. Гольдфарб М. В. 11, 1948
- Монозон Б. С., Игнатьева Л. А. Нелинейное магнитопоглощение в полупроводнике компоненты сильной бигармонической световой волны. 11. 1987
- Мончка Д., см. Жуковский П. В. 8, 1475
- Мордкович В. Н., см. Болдырев С. И. 2, 300
- Мордовец Н. А., см. Варванни Н. А. 4, 635
- Мороженко В. А., см. Коллюх А. Г. 5, 931
- Мороз Н. В., см. Птащенко А. А. 10, 1892
- Мороз С. Е., см. Козловский В. В. 6, 1123
- Мороз С. Е., см. Кольченко Т. И. 11, 1963
- Морозов Б. В., см. Журавлев К. С. 4, 702
- Морозов С. В., см. Дубровский Ю. В. 5, 928
- Мочалова Д. А., см. Курова И. А. 2, 314
- Мукашев Б. Н., см. Абдуллин Х. А. 2, 391
- Мунтяну Ф. М., см. Гицу Д. В. 12, 2205
- Мурьев А. В., см. Демиховский С. В. 12, 2151
- Муррина Т. М., см. Бузынин А. Н. 2, 264
- Мусабеков Е., см. Васильев В. А. 4, 710
- Мусалитин А. М., см. Даневский М. Я. 12, 2073
- Мусатов А. Л., Израэльянц К. Р., Коротких В. Л., Филиппов С. Л., Руссу Е. В., Дякону И. И. Эмиссионные характеристики полупроводниковых гетероструктур с барьером Шоттки InGaAs-InP-Ag . 9, 1523
- Мусатов А. Л., Филиппов С. Л., Руссу Е. В., Смирнов В. Г. Фотоэмиссия горячих электронов из диодов Шоттки $p\text{-InGaAs-Ag}$. 7, 1313
- Мынбаев К. Д., см. Миронов К. Е. 3, 582
- Мынбаев К. Д., см. Иванов-Омский В. И. 12, 2222
- Мырзин В. И., см. Андреев В. М. 7, 1194
- Мысливец К. А., см. Любченко А. В. 1, 171
- Мякенькая Г. С., Гуцев Г. Л., Герасименко Н. Н. Изолирующая примесь замещения элементов II и III периодов в нейтральном зарядовом состоянии в кристаллическом кремнии. 6, 1042
- Мякенькая Г. С., см. Гуцев Г. Л. 3, 479
- Мясников А. М., см. Герасименко Н. Н. 7, 1245
- Мясоедов Ю. Н., см. Яфясов А. М. 5, 875
- Надирзаде Р. С., см. Гашимзаде Ф. М. 4, 673
- Надточий Ю. М., см. Копьев П. С. 4, 747
- Назаров А. И., см. Гуртов В. А. 6, 969
- Назаров Н., см. Жилиев Ю. В. 7, 1303
- Назарчук П. Ф., см. Семшук А. К. 11, 2056
- Налбандян Л. В., см. Витман Р. Ф. 1, 45
- Намаянас А. М., см. Гярулайтис Д. А. 3, 563
- Натиг Б. А., см. Бахышов А. Э. 7, 1318
- Науменко Н. В., см. Фомин И. А. 2, 231
- Нгуен Хонг Шон. Фотостимулированный поперечный радиоэлектрический эффект при межзонной подсветке. 9, 1681
- Недеогло Д. Д., см. Болбошенко В. З. 11, 1929
- Неймаш В. Б., см. Емцев В. В. 2, 374
- Нейфельд Э. А., см. Городилов Н. А. 4, 664
- Неменов М. И., см. Алфёров Ж. И. 1, 152
- Немов С. А., Богатыренко Н. Г., Прошин В. И. Особенности энергетического спектра $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}(\text{Tl}, \text{Na})$. 8, 1391
- Немов С. А., см. Житинская М. К. 6, 1116
- Немов С. А., см. Житинская М. К. 9, 1589

- Несмелова И. М., см. Браташевский Ю. А. 2, 305
- Нетяга В. В., см. Григорчак И. И. 2, 386
- Неустроев Л. Н., см. Козловский Ю. Я. 3, 497
- Нечипорук Б. Д., см. Артамонов В. В. 10, 1747
- Никитенко В. Р., см. Архипов В. И. 11, 1923
- Никитенко В. Р., см. Архипов В. И. 11, 2043
- Никитин М. С., см. Аронзон Б. А. 4, 687
- Никитина И. П., см. Жилиев Ю. В. 7, 1303
- Николаенко Ю. М., см. Браташевский Ю. А. 2, 305
- Никольский Ю. А. Аномальный эффект Холла в пленках антимонида индия, выращенных на подложках из окисленного кремния. 7, 1322
- Никонов В. В., см. Гавриленко В. И. 5, 825
- Нинидзе Г. К., см. Добровольский В. Н. 6, 1067
- Нифтиев Н. Н., Тагиев О. Б., Рустамов А. Г. Оптические свойства монокристаллов $MnGa_2S_4$. 4, 758
- Ноах Н. М., см. Птащенко А. А. 10, 1892
- Новиков А. П., см. Александров П. А. 6, 1132
- Новиков Б. В., см. Болбошенко В. З. 11, 1929
- Новиков Е. Б., Хасиева Р. В., Шакишвили Г. А. Увеличение коротковолновой фоточувствительности $p-n-GaAlAs/GaAs$ -структур при химической обработке поверхности. 7, 1276
- Новиков С. В., см. Берт Н. А. 4, 653
- Новиков С. В., см. Бпрюлин Ю. Ф. 12, 2217
- Новиков С. В., см. Воробьева В. В. 6, 1026
- Новиков С. В., см. Крещук А. М. 6, 1145
- Новиков С. В., см. Крещук А. М. 6, 1145
- Новоселов С. К., см. Агранов Г. А. 3, 438
- Ноздрин Ю. Н., см. Генкин Г. М. 9, 1616
- Норейка Д. П., см. Борисова Т. Л. 11, 2005
- Нормурадов М. Т., см. Либенсон Б. Н. 1, 166
- Носков В. А., см. Дехтяр Ю. Д. 3, 492
- Няткишис В. В., см. Борисова Т. Л. 11, 2005
- Ободников В. И., см. Герасименко Н. Н. 7, 1245
- Огенко В. М., см. Ильченко Л. Г. 3, 576
- Огородников А. Д., см. Гертович Т. С. 1, 192
- Окомельков А. В., см. Генкин Г. М. 9, 1616
- Оконечников А. П., Мельник Н. Н., Гаврилов Ф. Ф. Влияние облучения позамы He^{2+} на диффузионную длину неосновных носителей заряда в $ZnSe$. 4, 747
- Окунев В. Д., Пафомов Н. Н. Кулоновская щель в спектре состояний $\alpha-CdGeAs_2(Fe)$. 11, 2064
- Олейник С. П., см. Ильичев Э. А. 5, 788
- Олейник С. П., см. Ильичев Э. А. 6, 978
- Олеск А. О., см. Глобус Т. Р. 1, 37
- Олеск С. А., Пихтия А. Н., Юнович А. Э. Механизмы излучательной рекомбинации в селениде свинца вблизи комнатной температуры. 5, 795
- Олеск С. А., см. Глобус Т. Р. 1, 37
- Олих Я. М., см. Любченко А. В. 1, 171
- Омельяновская Н. М., Итальянцев А. Г., Краснобаев Л. Я., Астахова Е. Ф. Образование глубоких уровней в $p-Si$ при газовом травлении в хлорсодержащей атмосфере. 11, 2040
- Омельяновская Н. М., см. Болдырев С. Н. 2, 300
- Омельяновский Э. М., см. Марков А. В. 3, 507
- Онаркулов К. Э., см. Атакулов Ш. Б. 10, 1884
- Опыськин А. Б., Оришин Ю. М., Савчин В. П., Стахира И. М., Фецюх И. М. Электронные свойства пленок моно- и субселенидов индия. 3, 423
- Опанасюк А. С., см. Денисенко В. Л. 5, 941
- Оришин Ю. М., см. Опыськин А. Б. 3, 423
- Орлов Л. К., Елиначев И. А. Пьезомодуляционный эффект в структурах с квантовыми ямами. 6, 987
- Ормонт Н. Н., см. Звягин И. П. 10, 1726
- Ормонт Н. Н., см. Звягин И. П. 11, 1992
- Освенский В. Б., см. Колин Н. Г. 1, 187
- Освенский В. Б., см. Марков А. В. 3, 507
- Осико В. В., см. Бузынин А. Н. 2, 264
- Осипов В. В., см. Ващенко В. А. 10, 1705
- Осипов В. В., см. Гафлийчук В. В. 4, 724
- Осипов В. В., см. Гафлийчук В. В. 7, 1282
- Осипов В. В., см. Козловский Ю. Я. 3, 497
- Осипов Е. Б., см. Аверкиев Н. С. 9, 1632
- Осташко Н. И., см. Крайчипский А. Н. 8, 1487
- Отман Я. И., см. Гермогенов В. П. 6, 1095
- Павелец С. Ю., Сванидзе Т. М., Гарасенко В. П. Тонкопленочные поликристаллические фотопреобразователи с МДП и ПДП структурами на основе теллурида кадмия. 11, 2058
- Павлов С. Г., см. Демиховский С. В. 12, 2151
- Павлов С. Т., см. Гашимадзе Ф. М. 4, 673
- Павловский М. В., см. Абдуллаев Х. О. 11, 1969
- Паксеев В. Е., см. Голин Л. Л. 7, 1259
- Пальчик Г. В., см. Литвинов В. В. 2, 376
- Памяти Анатолия Робертовича Регеля. 5, 954
- Памяти Олега Вячеславовича Снитко. 6, 1148
- Панахов М. М., см. Аскеров Б. М. 12, 2211

- Панов В. П., Панова Г. Д., Турьев А. М., Шейнкман М. К. Нестабильность проводимости пленок сульфида кадмия, обусловленная фото-стимулированной диффузией кислорода. 2, 388
- Панов М. Ф., см. Лупал М. В. 9, 1604
- Панова Г. Д., см. Панов В. П. 2, 388
- Папазян К. З., см. Абрамян Ю. А. 10, 1752
- Папенцев М. Г., см. Брунков П. Н. 11, 1978
- Паранчич Л. Д., см. Паранчич С. Ю. 2, 225
- Паранчич С. Ю., Паранчич Л. Д., Макогоненко В. Н., Лотоцкая С. В. Энергетическая щель и эффективная масса в твердых растворах $Fe_xHg_{1-x}Se$. 2, 225
- Парфенова И. И., Таиров Ю. М., Цветков В. Ф. Теплопроводность карбида кремния в области температур 300—3000 К. 2, 258
- Парфенюк О. А., см. Бабий П. И. 8, 1444
- Пафомов Н. Н., см. Окунев В. Д. 11, 2064
- Пашковский А. Б., см. Кальфа А. А. 3, 521
- Пашковский А. Б., см. Кальфа А. А. 7, 1187
- Пейкришвили М. Д., см. Адамшвили Г. Т. 10, 1878
- Пека Г. П., Пулеметов Д. А., Радзивилюк В. А., Смоляр А. Н. Динамические характеристики инжекционных фотодиодов с варизонной базой. * 4, 772
- Пека Г. П., Россохатый В. К., Смоляр А. Н. Температурные зависимости параметров переключения варизонных S-диодов. 8, 1494
- Пека Г. П., Токалин О. А., Хмичев А. И. Детектирование импульсного ионизирующего излучения с помощью варизонных структур. 4, 736
- Пека Г. П., см. Беднарский В. В. 8, 1371
- Пека Г. П., см. Кудинов В. А. 10, 1736
- Первова Л. Я., см. Ванем Р. А. 10, 1827
- Перепелкин А. Д., см. Яфясов А. М. 5, 875
- Перлин Е. Ю., см. Федоров А. В. 9, 1516
- Перов П. И., см. Поляков В. И. 11, 2017
- Пернцев С. К., см. Аблова М. С. 11, 1943
- Петренко В. В., см. Акулович Н. И. 3, 472
- Петричук М. В., см. Лукьянчикова Н. Б. 9, 1659
- Петров А. Г., Шик А. Я. Фотоионизация квантовых ям в сплюснем электрическом поле. 8, 1431
- Петров И. Н., см. Голикова О. А. 4, 768
- Петровский А. Н., см. Григорьев В. В. 11, 2031
- Петросян С. Г., см. Асрян Л. В. 12, 2121
- Петрунин А. П., см. Баранов И. А. 4, 731
- Петрусенко В. Н., см. Добровольский В. Н. 6, 1067
- Пещев В. В., Смородинов С. В. Температурные зависимости накопления центров $E10$ ($E_c - 0.62$ эВ) в n -InP. 5, 879
- Пийбе Т. Э., см. Крусток Ю. И. 10, 1888
- Питровский Т., см. Георгица Е. И. 10, 1732
- Питровский Т., см. Георгица Е. И. 12, 2160
- Пипа В. И., Яблоновский Е. И., Малютенко В. К. Фотомагнитный эффект в условиях дефицита фотонов. 7, 1175
- Пипа В. И., см. Болгов С. С. 9, 1677
- Пипа В. И., см. Малютенко В. К. 5, 866
- Пирагас К., см. Бумялене С. 9, 1509
- Писаревская В. А., см. Бирюлиш Ю. Ф. 12, 2219
- Пихтин А. Н., см. Лупал М. В. 9, 1604
- Пихтин А. Н., см. Олеск С. А. 5, 795
- Пичалко В. Д., Толстихин В. И. Эффекты разогрева носителей заряда в инжекционных гетеролазерах на InGaAsP/InP. 3, 462
- Плоппа М. Г., см. Бузынин А. Н. 2, 264
- Плоткин Д. А., см. Дьяконова Н. В. 5, 836
- Пляцко С. В., см. Громовой Ю. С. 2, 250
- Погорлецкий В. М., см. Амброс В. П. 8, 1375
- Погорлецкий В. М., см. Георгица Е. И. 10, 1732
- Погорлецкий В. М., см. Георгица Е. И. 12, 2160
- Погребницкий К. Ю., см. Берт Н. А. 4, 653
- Погребницкий К. Ю., см. Воробьева В. В. 6, 1026
- Покровский Я. Е. Контроль распределения примесей III и V групп в кремнии по интенсивности донорно-акцепторной люминесценции. 6, 1006
- Покровский Я. Е., см. Алтухов И. В. 6, 1134
- Полетаев Н. К., см. Жилиев Ю. В. 7, 1303
- Половцев И. С., см. Баграев Н. Т. 9, 1557
- Половцев И. С., см. Баграев Н. Т. 9, 1563
- Полторацкий Э. А., см. Гергель В. А. 12, 2111
- Полыгалов Ю. И., Поплавной А. С. Зонная структура короткопериодичных (001)-сверхрешеток $(AlAs)_n(GaAs)_n$. 2, 328
- Полыгалов Ю. И., см. Басалаев Ю. М. 5, 916
- Поляков А. Я., см. Марков А. В. 3, 507
- Поляков В. И., Перов П. И., Ермаков М. Г., Ермакова О. Н., Мокеров В. Г., Медведев Б. К. Фотоэлектрические характеристики многослойных $p^+ - i - n^+$ -структур GaAs—AlGaAs с квантовыми ямами. 11, 2017
- Поляков Д. Г., см. Копьев П. С. 7, 1200
- Помозов Ю. В., Хпруненко Л. И., Шаховцов В. И., Яшняк В. И. Трансформация точечных дефектов при отжиге Si и Si : Ge, облученных нейтронами. 6, 993
- Помарев Я. Г., см. Гицу Д. В. 12, 2205

- Поплавной А. С., см. Басалаев Ю. М. 5, 916
- Поплавной А. С., см. Полыгалов Ю. И. 2, 328
- Попов В. А., см. Лупал М. В. 9, 1604
- Попов В. В., см. Хасбулатов А. М. 6, 1136
- Попов И. В., см. Кондратьев Б. С. 4, 647
- Поссе В. А., см. Конников С. Г. 2, 271
- Поссе Е. А., см. Берковиц В. Л. 2, 353
- Поссе Е. А., см. Джамабалин К. К. 12, 2089
- Постников В. С., Борисов В. С., Капустин Ю. А., Кириллов В. И. Динамическая релаксация в компенсированном кремнии. 5, 855
- Постолов И. Т., см. Амброс В. П. 8, 1375
- Преображенский В. В., см. Лубышев Д. И. 10, 1862
- Прима Н. А., см. Климовская А. И. 12, 2094
- Примбердиев К. Ж., см. Собиров М. М. 8, 1417
- Прозоровский В. Д., см. Браташевский Ю. А. 2, 305
- Прокофьева Л. В., см. Алексеева Г. Т. 12, 2155
- Прохорович А. В., см. Впник Е. В. 8, 1363
- Прошин В. И., см. Житинская М. К. 6, 1116
- Прошин В. И., см. Немов С. А. 8, 1391
- Пруцких Т. А., см. Андреев В. М. 10, 1757
- Птащенко А. А., Мороз Н. В., Ноах Н. М. Природа «рекомбинационного» тока в $p-n$ -переходах с неоднородностями.* 10, 1892
- Птицина Н. Г., см. Воеводин Е. И. 10, 1881
- Птицын В. Ю., см. Глинчук К. Д. 9, 1685
- Пулатова Д. С., см. Хакимов З. М. 1, 29
- Пулеметов Д. А., см. Пека Г. П. 4, 772
- Пшеничная А. Н., см. Ильин М. А. 5, 800
- Пятраускас М. Б., см. Борцова Т. Л. 11, 2005
- Пятраускас М., см. Вайткус Ю. 11, 1919
- Рагимов Р. Н., см. Араслы Д. Г. 2, 365
- Раданцев В. Ф., см. Дерябина Т. И. 7, 1182
- Радаудан С. И., Сырбу Н. Н., Львин В. Э., Доника Ф. Г. Колебательные спектры кристаллической решетки полупроводников соединений $Zn_mIn_{3-m}S_3$. 9, 1592
- Радаудан С. И., см. Коршунов Ф. П. 11, 2034
- Радзивилюк В. А., см. Пека Г. П. 4, 772
- Радченко М. В., см. Лашкарев Г. В. 3, 418
- Райх М. Э., см. Аскеров Б. М. 12, 2211
- Райчев О. Э., см. Грибников З. С. 2, 346
- Райчев О. Э., см. Грибников З. С. 5, 940
- Райчев О. Э., см. Грибников З. С. 7, 1222
- Райчев О. Э., см. Грибников З. С. 10, 1772
- Раммо И. Х. Ф., см. Вирро А. Л. 7, 1158
- Раренко И. М., см. Баранский П. И. 8, 1490
- Раренко И. М., см. Глузман Н. Г. 10, 1766
- Резников Б. И., Царенков Г. В. Нестационарный фотоэффект в варизонной $m-p-n$ -структуре. III. Ток короткого замыкания. 2, 276
- Резников Б. И., Царенков Г. В. Нестационарный фотоэффект в варизонной $m-p-n$ -структуре. IV. Влияние внешней нагрузки. 6, 1079
- Решина П. И. Комбинационное рассеяние света фотондупированной плазмой в двойных гетероструктурах. 10, 1800
- Решина П. И., см. Копьев П. С. 7, 1200
- Рогоцкий И. С., см. Крайчинский А. Н. 8, 1487
- Родина А. В., см. Гельмонт Б. Л. 1, 198
- Родичев Д. Ю., см. Чудинов С. М. 11, 1905
- Рожкова Е. В., см. Белянский М. П. 11, 2046
- Рознован Ю. В., см. Арушанов Э. К. 7, 1179
- Романов А. В., см. Гузь В. Н. 3, 409
- Романов В. В., см. Штельмах К. Ф. 8, 1482
- Романов В. В., см. Штельмах К. Ф. 9, 1584
- Романов Ю. А., см. Алешкин В. Я. 1, 131
- Романова Ю. Ю., см. Белянцев А. М. 4, 692
- Романюк Б. Н., см. Артамонов В. В. 10, 1747
- Россохатый В. К., см. Пека Г. П. 8, 1494
- Рощупкин С. П., см. Денисенко В. Л. 5, 941
- Рудь В. Ю., Рудь Ю. В. Анизотропия переноса носителей заряда в монокристаллах $CdGeAs_2$. 12, 2181
- Рудь Ю. В., см. Медведкин Г. А. 7, 1306
- Рудь Ю. В., см. Рудь В. Ю. 12, 2181
- Руленико М. П., см. Белянский М. П. 11, 2046
- Руленико М. П., см. Вейс А. Н. 1, 126
- Румянцев В. Д., см. Андреев В. М. 10, 1757
- Румянцев С. Л., см. Гук Е. Г. 5, 813
- Румянцев С. Л., см. Дьяконова Н. В. 5, 836
- Румянцев С. Л., см. Дьяконова Н. В. 9, 1531
- Румянцев С. Л., см. Левинштейн М. Е. 10, 1807
- Руссу Е. В., см. Абдуллаев Х. О. 11, 1969
- Руссу Е. В., см. Мусатов А. Л. 7, 1313
- Руссу Е. В., см. Мусатов А. Л. 9, 1523
- Рустамов А. Г., см. Нифтиев Н. Н. 4, 758
- Рухадзе З. А., см. Валейко М. В. 8, 1437
- Рыбак А. М., см. Малютенко В. К. 8, 1467
- Рывкин Б. С., см. Бутусов Д. М. 6, 1062
- Рыжий В. И., Семькина Е. А. К теории полевого полупроводникового инжектора с туннельно-резонансной структурой. 1, 115
- Рыжий В. И., см. Долманов И. Н. 9, 1574
- Рыжий В. И., см. Ершов М. Ю. 7, 1265

- Рыжков М. П. Функция генерации фотоносителей в варизонных полупроводниках. 6, 1114
- Рыков С. А., см. Кайданов В. И. 1, 144
- Рыкова М. А., см. Кайданов В. И. 1, 144
- Рыльков В. В., см. Веденеев А. С. 6, 1141
- Рысбаев А. С., см. Либенсон Б. Н. 1, 166
- Рябова Л. И., см. Каширская Л. М. 8, 1349
- Саакян А. А., см. Болдырев С. Н. 2, 300
- Сабирзянова Л. Д., см. Глузман Н. Г. 10, 1766
- Савваитова Ю. А., см. Дехтяр Ю. Д. 3, 492
- Савельев И. Г., см. Берг Н. А. 4, 653
- Савельев И. Г., см. Воробьева В. В. 6, 1026
- Савельев И. Г., см. Крещук А. М. 6, 1145
- Савинова Н. А., см. Бордовский Г. А. 2, 342
- Савченко А. П., см. Аюпян А. А. 10, 1875
- Савченко А. П., см. Болгов С. С. 9, 1677
- Савченко А. П., см. Болгов С. С. 9, 1598
- Савчин В. П., см. Оныськин А. Б. 3, 423
- Сагалович Г. Л., см. Дехтяр Ю. Д. 3, 492
- Сайфидинов Д. Ж., см. Берг Н. А. 4, 653
- Салманов А. Р., см. Гаубас Э. 4, 773
- Сальник А. О., см. Григорьев В. В. 11, 2031
- Салюк О. Ю., см. Аюпян А. А. 10, 1875
- Самедов С. Р., см. Бахышов А. Э. 7, 1318
- Сапега В. Ф., см. Копьев П. С. 7, 1200
- Сафронов Е. Ю., см. Синявский Э. П. 7, 1299
- Сафронов Л. Н., см. Герасименко Н. Н. 7, 1245
- Сафурат Б., см. Бахышов А. Э. 7, 1318
- Сванидзе Т. М., см. Павелец С. Ю. 11, 2058
- Свердлов В. А., см. Ермолин А. В. 12, 2197
- Свердлов М. И., см. Конников С. Г. 11, 2010
- Свечников С. В., см. Быковский В. Ю. 2, 287
- Свешников А. А., см. Глебов С. С. 9, 1689
- Свешников А. А., см. Капустин Ю. А. 2, 318
- Селяков А. Ю., см. Кернер Б. С. 8, 1455
- Семашко Е. М., см. Крещук А. М. 6, 1145
- Семенюк А. К., Назарчук П. Ф. Изменение энергии ионизации радиационного дефекта с уровнем $E_c - 0.2$ эВ в α -Si при одноосной деформации. 11, 2056
- Семенюк Ю. А., Шаховцова С. И., Белокурова И. Н. Низкотемпературный примесный пробой в сплавах германий—кремний. 7, 1272
- Семькина Е. А., см. Рыжий В. И. 1, 115
- Семягин Б. Р., см. Альперович В. Л. 3, 451
- Семягин Б. Р., см. Лубышев Д. И. 10, 1862
- Сеничкин А. П., см. Кадушкин В. И. 6, 1109
- Сеничкин А. П., см. Кадушкин В. И. 6, 1111
- Сеничкин А. П., см. Кадушкин В. И. 7, 1279
- Сеничкин А. П., см. Кадушкин В. И. 12, 2080
- Сергеев Д. В., см. Жилиев Ю. В. 7, 1303
- Сигалович Г. Л., см. Дехтяр Ю. Д. 4, 757
- Сизов Ф. Ф., см. Громовой Ю. С. 2, 250
- Симашкевич А. В., см. Горя О. С. 8, 1496
- Син Сюй, см. Ван Си-фу. 4, 631
- Синис В. П., см. Алтухов И. В. 6, 1134
- Синкевич В. Ф., см. Ващенко В. А. 10, 1705
- Синявский Э. П., Сафронов Е. Ю. Особенности однофононного захвата электрона в магнитном поле. 7, 1299
- Сиповская М. А., см. Баранов А. Н. 1, 98
- Сиповская М. А., см. Баранов А. Н. 6, 1072
- Сирацкий В. М., Шаховцов В. И., Шиндич В. Л., Шпинар Л. И., Ясковец И. И. Электронные свойства бистабильных дефектов. 10, 1795
- Сиренко А. А., см. Копьев П. С. 7, 1200
- Скипетров Е. П., см. Брандт Н. Б. 1, 151
- Скипетров Е. П., см. Дмитриев В. В. 5, 897
- Скипетров Е. П., см. Дубков В. П. 1, 104
- Скипетров Е. П., см. Ковалев Б. Б. 8, 1379
- Скипидаров С. Я., см. Азоу С. А. 2, 283
- Скрышевский В. А., Литвиненко С. В., Стриха В. И. Датчик электронов на основе кремниевого барьера Шоттки со слоем туниельно-прозрачного диэлектрика. 10, 1886
- Скрышевский В. А., см. Воскобойников А. М. 3, 413
- Слынько В. В., см. Бабий П. И. 8, 1444
- Слынько Е. И., см. Брандт Н. Б. 1, 51
- Смекалкин К. Е., см. Миятаилов А. М. 9, 1539
- Смертенко П. С., см. Гусев М. Ю. 8, 1413
- Смирнов В. А., см. Баженов Н. Л. 1, 93
- Смирнов В. А., см. Георгица Е. И. 10, 1732
- Смирнов В. А., см. Георгица Е. И. 12, 2160
- Смирнов В. Г., см. Мусатов А. Л. 7, 1313
- Смирнов Л. С., см. Ахметов В. Д. 1, 72
- Смирнова О. И., см. Алтухов И. В. 6, 1134
- Смоляр А. Н., см. Кудинов В. А. 10, 1736
- Смоляр А. Н., см. Пека Г. П. 4, 772
- Смоляр А. Н., см. Пека Г. П. 8, 1494

- Смоляр В. В., см. Воскобойников А. М. 3, 413
- Смородинов С. В., см. Пешев В. В. 5, 879
- Сморчкова Ю. П., см. Афрайлов М. А. 8, 1397
- Снапиро И. Б., Ткаченко Н. Н. Фотомангнитный эффект в поликристаллическом полупроводнике.* 4, 773
- Собиров М. М., Примбердиев К. Ж. Двукратное резонансное рассеяние света с участием акустических фононов в CdS. 8, 1417
- Соболев М. М., см. Брунков П. Н. 7, 1320
- Соболев М. М., см. Брунков П. Н. 11, 1978
- Соболев Н. А., см. Арутюнов Н. Ю. 10, 1785
- Соболев Н. А., см. Коршунов Ф. П. 11, 2034
- Соболев Н. В., см. Солдатов В. С. 9, 1611
- Соколина Г. А., Ботев А. А., Буйлов Л. Л., Банцевков С. В., Лазарева О. И., Белянин А. Ф. Температурные и частотные зависимости электропроводности алмазных пленок. 1, 175
- Соколов А. П., Шебанни А. П. Структурная упорядоченность и оптические свойства аморфного кремния. 6, 1138
- Соколов В. Д., см. Дошанов К. М. 8, 1407
- Солдатов В. С., Воеводин А. Г., Варламов И. Б., Коляда В. А., Соболев Н. В. Пространственное распределение зарядов, прогенерированных туннельной инжекцией электронов из кремния в термической диоксид МДП структуры. 9, 1611
- Соловьев В. А., см. Конников С. Г. 2, 271
- Соловьева Е. В., см. Лагвилава Т. А. 8, 1367
- Солончук И. В., см. Выграненко Ю. К. 2, 392
- Соляков А. Н., см. Гергель В. А. 12, 2111
- Сосников И. П., см. Берт Н. А. 4, 653
- Сталенис А., см. Балинас В. 5, 848
- Станев Н., см. Борисова Т. Л. 11, 2005
- Стариков Е. В., см. Гавриленко В. И. 5, 825
- Стась В. Ф., Чистохин И. Б., Герасименко Н. Н. Взаимодействие галлия с радиационными дефектами в кремнии. 3, 512
- Стафеев В. И., см. Абрамян Ю. А. 10, 1752
- Стахира И. М., см. Оныськив А. Б. 3, 423
- Стебловский Г. И., см. Васько Ф. Т. 1, 59
- Стельмах В. Ф., см. Босак В. И. 3, 570
- Стельмах В. Ф., см. Жуковский П. В. 8, 1473
- Стельмах В. Ф., см. Жуковский П. В. 8, 1475
- Стенин С. И., см. Лубышев Д. И. 10, 1862
- Степуренко А. А., Алиев К. М., Абакарова Н. С. Акустоэлектронное взаимодействие в Те и CdS в сильном магнитном поле. 4, 678
- Стовповой М. А., см. Крещук А. М. 6, 1145
- Стрекалов В. Н. Неравновесное испарение полупроводников, обусловленное тормозным поглощением света. 11, 2048
- Стрельчук А. М., см. Аникин М. М. 8, 1384
- Стрельчук А. М., см. Кондратьев Б. С. 4, 647
- Стрельчук В. В., см. Артамонов В. В. 10, 1747
- Стриха В. И., см. Воскобойников А. М. 3, 413
- Стриха В. И., см. Скрышевский В. А. 10, 1886
- Стриха М. В., см. Васько Ф. Т. 7, 1227
- Строкан Н. Б., см. Андреев В. М. 3, 585
- Стук А. А., см. Супрунич В. В. 6, 1014
- Субачюс А., см. Ашмонтас С. 12, 2214
- Сукач Г. А., Сыпко Н. И. Влияние нейтронного облучения на спектры электролюминесценции прямогозонаного GaAsP, легированного цинком. 2, 368
- Сулима О. В., см. Брунков П. Н. 7, 1320
- Султанова А. Г., см. Кязым-заде А. Г. 10, 1873
- Сумарока А. М., см. Гольдман Е. И. 3, 503
- Супрунич В. В., Демчук Д. Л., Иванов И. С., Стук А. А. Дефекты структуры в сильно легированном бором кремнии, облученном нейтронами. 6, 1014
- Сурис Р. А., Щамхалова Б. С. Проводимость полупроводниковой сверхрешетки в магнитном поле, перпендикулярном ее оси. 9, 1638
- Сурис Р. А., см. Бугусов Д. М. 6, 1062
- Суханов А. Н., см. Кернер Б. С. 8, 1455
- Суханов В. Л., см. Баграев Н. Т. 9, 1557
- Суханов В. Л., см. Баграев Н. Т. 9, 1563
- Суханов В. Л., см. Варданын Р. Р. 3, 485
- Счастный В. В., см. Иванюкович В. А. 11, 2051
- Сыпко Н. И., см. Сукач Г. А. 2, 368
- Сырбу Н. Н., Львин В. Э. Колебательные спектры кристаллов CdP₂. 11, 1911
- Сырбу Н. Н., см. Радауцан С. И. 9, 1592
- Сыркин А. Л., см. Авикин М. М. 8, 1384
- Сыродоев Г. А., см. Крючков С. В. 5, 913
- Сыродоев Г. А., см. Крючковой С. В. 6, 1120
- Сырых А. Д., см. Добровольский В. Н. 6, 1103
- Сюрис О. В., см. Кайданов В. И. 1, 144
- Табаров Т. С., см. Абдуллаев Х. О. 11, 1969
- Табаров Т. С., см. Алфёров Ж. И. 2, 361
- Тагиев Б. Г., Гаджиев А. Р., Тагиев Т. Б. Инжекционные токи в слоистых кристаллах теллурида галлия.* 8, 1497
- Тагиев О. Б., см. Нифтиев Н. Н. 4, 758
- Тагиев Т. Б., см. Тагиев Б. Г. 8, 1497

- Т а д е у ш Н. Н., см. Жуковский П. В. 8, 1473
- Т а и р о в М. А., см. Медведкин Г. А. 7, 1306
- Т а и р о в Ю. М., см. Андреев А. П. 5, 824
- Т а и р о в Ю. М., см. Парфенова И. И. 2, 258
- Т а л и п о в Ф. М. Влияние электронного облучения на электрические свойства кремния, диффузионно-легированного марганцем. 8, 1472
- Т а л и п о в Ф. М., Бахадурханов М. К. Влияние никеля на образование термодоноров в монокристаллах кремния. 12, 2202
- Т а м а ш я в и ч е н е З. Н., см. Гярулайтис Д. А. 3, 563
- Т а м а ш я в и ч ю с А. В., см. Гярулайтис Д. А. 3, 563
- Т а м е н д а р о в М. Ф., см. Абдуллин Х. А. 2, 391
- Т а н а н а е в а О. И., см. Каширская Л. М. 8, 1349
- Т а н к л е в с к а я Е. М., см. Андреев В. М. 10, 1757
- Т а р а н о в М. Л., см. Кондратьев Б. С. 4, 647
- Т а р а с е в и ч А. Д., см. Иванюкович В. А. 11, 2051
- Т а р а с е н к о А. А., Чумаков А. А. Влияние магнитного поля на электропроводность полупроводников в условиях резонансного рассеяния носителей тока. 10, 1742
- Т а р а с е н к о В. П., см. Павелец С. Ю. 11, 2058
- Т а р х и н Д. В., см. Андреев В. М. 3, 585
- Т а р ч е н к о В. П., см. Иващенко А. И. 6, 1001
- Т а с к и н А. А., см. Герасименко Н. Н. 2, 391
- Т а т а р и н ц е в В. М., см. Бузынин А. Н. 2, 264
- Т а ш е н о в Т. Б., см. Абдуллин Х. А. 2, 391
- Т е п л и ц к и й В. А., см. Балтрамеюнас Р. 9, 1550
- Т е р е х о в А. С., см. Журавлев К. С. 4, 702
- Т е р л е ц к и й И. А., см. Штельмах К. Ф. 8, 1482
- Т е р л е ц к и й И. А., см. Штельмах К. Ф. 9, 1584
- Т е р у к о в Е. И., см. Атаев Ж. 3, 488
- Т е р у к о в Е. И., см. Васильев В. А. 4, 710
- Т и г н я н у И. М., см. Коршунов Ф. П. 11, 2034
- Т и м о ш к и н В. Н., см. Бриллиантов Н. В. 5, 860
- Т и т к о в А. Н., Чебан В. Н., Баранов А. Н., Гусейнов А. А., Яковлев Ю. П. Природа спонтанной электролюминесценции гетероструктур II-типа GaInAsSb/GaSb. 6, 1056
- Т и ш к и н М. В., см. Марков А. В. 3, 507
- Т и ш к о в с к и й Е. Г., см. Герасименко Н. Н. 2, 391
- Т к а ч е н к о В. Н., см. Берман Л. С. 7, 1213
- Т к а ч е н к о В. Н., см. Берман Л. С. 10, 1816
- Т к а ч е н к о В. Н., см. Берман Л. С. 10, 1844
- Т к а ч е н к о В. Н., см. Берман Л. С. 12, 2186
- Т к а ч е н к о Н. Н., см. Снапиро И. Б. 4, 773
- Т о в с т ю к К. Д., см. Гертович Т. С. 1, 192
- Т о к а л и н О. А., см. Пека Г. П. 4, 736
- Т о л с т и х и н В. И., см. Долманов И. Н. 2, 334
- Т о л с т и х и н В. И., см. Долманов И. Н. 9, 1574
- Т о л с т и х и н В. И., см. Пищалко В. Д. 3, 462
- Т о м а ш ю н а с Р., см. Вайткус Ю. 11, 1919
- Т о р ч и н с к а я Т. В., Карабаев А. Г., Шейнкман М. К. Инжекционно-стимулированная трансформация спектров люминесценции зеленых GaP: N-светодиодов. 8, 1337
- Т р а в к о в И. В., см. Гуртов В. А. 6, 969
- Т р а в н и к о в В. В., см. Жилиев Ю. В. 7, 1303
- Т р а х б р о т Б. М., см. Андреевский Е. Н. 12, 2136
- Т р а щ а к о в В. Ю., см. Арутюнов Н. Ю. 10, 1785
- Т р о ш к о в С. И., см. Гольдберг Ю. А. 10, 1835
- Т р о ш к о в С. К., см. Мезрин О. А. 4, 638
- Т р о я н о в с к и й В. С., см. Агранов Г. А. 3, 438
- Т у м а н и ш в и л и Э. П., см. Мириана-швили Ш. М. 3, 574
- Т у м к я в и ч ю с К., см. Вайткус Ю. 11, 1919
- Т у р п е в А. М., см. Панов В. П. 2, 388
- Т у р с у н о в Ш. С., см. Адипов К. А. 9, 1624
- Т ы с ч е н к о И. Б., см. Каранович А. А. 6, 1101
- Т ы ч к и н а С. В., см. Жарких Ю. С. 11, 2062
- У г р и н Ю. О., см. Шерегий Е. М. 6, 1047
- У л ь я ш и н А. Г., см. Бумай Ю. А. 12, 2141
- У м а н с к и й В. Е., см. Конников С. Г. 2, 271
- У р а з б а е в Р. А., см. Казанский А. Г. 6, 1143
- У р е н е в В. И., см. Литвинов В. В. 2, 376
- У р с у В. А., см. Коршунов Ф. П. 11, 2034
- У с е й н о в Р. Г., Зебрев Г. И. Простой метод определения плотности поверхностных состояний по температурным измерениям ВАХ МОП транзисторов. 4, 752
- У с е й н о в Р. Г., см. Зебрев Г. И. 4, 777
- У с т и н о в В. М., см. Алферов Ж. И. 1, 152
- У с т и н о в В. М., см. Копьев П. С. 5, 717
- У с т и н о в В. М., см. Минтаиров А. М. 9, 1539
- У т е н к о В. И., см. Акулович Н. И. 3, 472
- У т е н к о В. И., см. Борисова Т. Л. 11, 2005
- У т у р а ш в и л и Г. Г., см. Адамашвили Г. Т. 10, 1878
- Ф а н т и к о в О. И., см. Агранов Г. А. 3, 438
- Ф а с т ы к о в с к и й П. П., Канчуковский О. П. Изменение высоты

потенциального барьера контактов металл—кремний в условиях деформации. 2, 310
 Федоров А. В., Перлин Е. Ю. Межзонные оптические переходы в легированных многодолинных полупроводниках. 9, 1516
 Федоров Л. М., см. Жилияев Ю. В. 7, 1303
 Федосов А. В., Букалов В. Р., Ящинский Л. В. Особенности пьезопротивления γ -облученного n -Ge при подсветке. 4, 754
 Феофанов Г. Н., см. Болотов В. В. 10, 1697
 Фетисова В. И., см. Фомин И. А. 2, 231
 Фецох И. М., см. Оныськин А. Б. 3, 423
 Филатов В. И., см. Вяткин А. П. 1, 109
 Филатов В. Н., см. Караваев В. В. 7, 1234
 Филатов И. И., см. Горфинкель В. Б. 4, 742
 Филатова Е. О., Кожахметов С. К., Виноградов А. С., Благовещенская Т. А. Исследование распределения нарушений в имплантированном кремнии методом ультрамягкой рентгеновской рефлектометрии. 7, 1216
 Филипович Н. Н., см. Коржув М. А. 5, 805
 Филиппов И. М., см. Казакевич Л. А. 3, 517
 Филиппов С. Л., см. Мусатов А. Л. 7, 1313
 Филиппов С. Л., см. Мусатов А. Л. 9, 1523
 Флипченко В. Я., см. Конников С. Г. 11, 2010
 Филонов Н. Г., см. Вяткин А. П. 1, 109
 Фирсов Т. В., см. Михнович В. В. 1, 181
 Фистуль В. И., Шмугуров В. А. Премущественное положение примесей IV группы в арсениде галлия. 6, 1038
 Фистуль В. И., см. Волков Д. А. 3, 475
 Фистуль В. И., см. Клингер П. М. 6, 1118
 Фомин И. А., Фетисова В. И., Анненко Н. М., Науменко Н. В. Исследование эпитаксиальных слоев $InGaAsP$ с низким уровнем легирования. 2, 231
 Фомичев С. И., см. Кадушкин В. И. 7, 1279
 Фриденстал Я. К., см. Вирро А. Л. 7, 1158
 Фукс Б. И. Низкочастотный шум в легированных полупроводниках. 11, 2036
 Фукс Б. И., см. Бугаева Т. В. 7, 1291
 Хавтаси Л. Г., см. Мирианашвили Ш. М. 3, 574
 Хазанов А. А., см. Конников С. Г. 11, 2010
 Хайбуллин И. Б., см. Барышев Н. С. 2, 363
 Хакимов З. М., Пулатова Д. С., Адилов М. К., Махмудов А. Ш., Левин А. А., Юнусов М. С. Распределение заряда и формирование глубоких уровней в полупроводниках по данным самосогласованного метода функций Грина: дефекты в кремнии и германии. 1, 29
 Хакимов К., см. Вавилов В. С. 12, 2132
 Халлер Ю. Э., см Вирро А. Л. 7, 1158
 Хасбулатов А. М., Машовец Д. В., Попов В. В. Эффект отрицательного сопротивления в $Cd_{0.1}Hg_{0.9}Te$. 6, 1136
 Хасиева Р. В., см. Берковиц В. Л. 2, 353
 Хасиева Р. В., см. Берковиц В. Л. 6, 1031
 Хасиева Р. В., см. Новиков Е. Б. 7, 1276
 Хвостиков В. П., см. Андреев В. М. 10, 1757
 Хвостиков В. П., см. Минтапоров А. М. 9, 1539
 Хемедда О. М., см. Доброго В. П. 3, 555
 Химичев А. П., см. Пека Г. П. 4, 736
 Хирунцов Л. И., Шаховцов В. И., Шинкаренко В. К., Воробкало Ф. М. Структура IK поглощения кислорода в германии. 6, 1051
 Хируненко Л. И., см. Критская Т. В. 6, 1129
 Хируненко Л. И., см. Маринченко А. В. 6, 1126
 Хируненко Л. И., см. Помозов Ю. В. 6, 993
 Хитько В. И., см. Борисова Т. Л. 11, 2005
 Хлебов А. Г., см. Вывенко О. Ф. 9, 1650
 Ходжасев К. Х., см. Аблова М. С. 11, 1943
 Холпина Е. Н., см. Авакянц Л. П. 1, 193
 Хорош А. Г., см. Брайт Н. Б. 1, 51
 Храмченков Д. В., см. Архипов В. И. 9, 1618
 Хрящев Г. С., см. Герасименко Н. Н. 7, 1245
 Хухрянский М. Ю., см. Вавилов В. С. 12, 2132
 Царенков Б. В., см. Бычковский Д. Н. 10, 1848
 Царенков Б. В., см. Гольдберг Ю. А. 10, 1835
 Царенков Б. В., см. Константинов О. В. 12, 2126
 Царенков Г. В., см. Резников Б. И. 2, 276
 Царенков Г. В., см. Резников Б. И. 6, 1079
 Цветков В. Ф., см. Андреев А. П. 5, 821
 Цветков В. Ф., см. Парфенова И. И. 2, 258
 Целищев С. Л., см. Вывенко О. Ф. 12, 2208
 Целевич С. О., см. Баранов И. А. 4, 731
 Цзян Вэй, см. Ван Си-фу. 4, 631
 Цидильковский И. М. Бесщелевые полумагнитные полупроводники $HgFeSe$ (обзор). 4, 593
 Цидильковский И. М., см. Аронзон Б. А. 4, 687
 Цикунов А. В., см. Казакевич Л. А. 3, 517
 Цыпишка Д. И., см. Георгицэ Е. И. 10, 1823
 Цыпленков И. И., см. Быковский В. А. 1, 77
 Цыпленков И. И., см. Коршунов Ф. П. 11, 2034

- Ц ан д и н К. Д. Особенности примесной проводимости в неупорядоченных полупроводниках, имеющих собственные дефекты с отрицательной корреляционной энергией и электрически активные примесные атомы. 6, 1019
- Ц ан д и н К. Д., см. Мазец Т. Ф. 11, 1953
- Ч ай ка Г. Е., см. Вавилов В. С. 2, 379
- Ч ал ды ше в В. В., см. Акимченко И. П. 10, 1857
- Ч ал ды ше в В. В., см. Быковский В. А. 1, 77
- Ч ал ды ше в В. В., см. Гермогенов В. П. 6, 1095
- Ч ал ды ше в В. В., см. Лубышев Д. И. 10, 1862
- Ч ап ни н В. А., см. Авакянц Л. П. 1, 193
- Ч ар ы ко в Н. А., см. Литвак А. М. 12, 2106
- Че ба н В. Н., см. Титков А. Н. 6, 1056
- Чел но ков В. Е., см. Васильев В. А. 4, 740
- Ч е н и с А., см. Бумялене С. 9, 1509
- Ч е р ны ше в С. В., см. Васильев В. А. 4, 740
- Ч и к и че в С. И., см. Журавлев К. С. 9, 1645
- Ч и ко ва н Н. И., см. Мирианавилин Ш. М. 3, 574
- Ч и ст о х и н И. Б., см. Стась В. Ф. 3, 512
- Ч и ст ы ко в В. М., см. Конников С. Г. 2, 271
- Ч и х р а й Е. В., см. Абдуллин Х. А. 2, 391
- Ч уд и но в С. М., Кульбачинский В. А., Манчини Дж., Медведев Б. К., Родичев Д. Ю. Квантовый эффект Холла и g -фактор 2D-электронов в гетероструктурах на основе GaAs. 11, 1905
- Ч у к и че в М. В., см. Вавилов В. С. 12, 2132
- Ч у ма к А. А., см. Тарасенко А. А. 10, 1742
- Ч у ма ко в Н. К., см. Аронзон Б. А. 4, 687
- Ч у со в И. И., см. Бугаева Т. В. 7, 1291
- Ша ги му ра то в О. Г., см. Веденеев А. С. 6, 1141
- Ша д р и н В. Д. К теории пограничных состояний в гетеропереходах. 3, 456
- Ш ай ме ев С. С., см. Антонова И. В. 7, 1240
- Ша ки а ш ви ли Г. А., см. Новиков Е. Б. 7, 1276
- Ша по ш ни ко в С. В., см. Алфёров Ж. И. 1, 152
- Ша по ш ни ко в С. В., см. Алфёров Ж. И. 2, 359
- Ш ар ла й Е. С., см. Гертович Т. С. 1, 192
- Ш а ст и н В. Н., см. Генкин Г. М. 9, 1616
- Ш а ст и н В. Н., см. Демиховский С. В. 12, 2151
- Ша х ле в и ч Л. Н., см. Баранов И. А. 4, 731
- Ша х ов ц о в В. И., см. Емцев В. В. 2, 374
- Ша х ов ц о в В. И., см. Кривская Т. В. 6, 1129
- Ша х ов ц о в В. И., см. Маринченко А. В. 6, 1126
- Ша х ов ц о в В. И., см. Помозов Ю. В. 6, 993
- Ша х ов ц о в В. И., см. Сирацкий В. М. 10, 1795
- Ша х ов ц о в В. И., см. Хируненко Л. И. 6, 1051
- Ша х ов ц о ва С. И., см. Семенюк Ю. А. 7, 1272.
- Ша ш ко ва В. В., см. Агринская Н. В. 4, 697
- Ш ва н г ра д зе Р. Р., см. Джамагидзе Ш. З. 9, 1670
- Ш е ба ни н А. П., см. Соколов А. П. 6, 1138
- Ш е в че н ко Н. В., см. Баранский П. И. 8, 1490
- Ш е в че н ко Н. В., см. Беляев А. Е. 11, 1999
- Ш ей н к ма н М. К., см. Панов В. П. 2, 388
- Ш ей н к ма н М. К., см. Торчинская Т. В. 8, 1337
- Ш ек Е. И., см. Арутюнов Н. Ю. 10, 1785
- Ш е л ко в ни ко в Д. Н., см. Бирюлин Ю. Ф. 12, 2217
- Ш е лу ш и на Н. Г., см. Городилов Н. А. 4, 664
- Ш е ма р до в С. Г., см. Александров П. А. 6, 1132
- Ш е ра у хо в В. А., см. Коршунов Ф. П. 11, 2034
- Ш е ре г и й Е. М., Угрин Ю. О. Двухфононные процессы и межзонные переходы в магнитофононном резонансе дырок в InSb. 6, 1047
- Ш е р ня ко в Ю. М., см. Васильев В. А. 4, 710
- Ш е р ст не в В. В., см. Афраплов М. А. 8, 1397
- Ш и к А. Я., см. Асрян Л. В. 12, 2121
- Ш и к А. Я., см. Берг Н. А. 4, 653
- Ш и к А. Я., см. Крещук А. М. 6, 1145
- Ш и к А. Я., см. Мезрин О. А. 4, 638
- Ш и к А. Я., см. Петров А. Г. 8, 1431
- Ш и к и н В. Б., см. Шикина Н. И. 11, 2067
- Ш и к и н В. Б., см. Шикина Н. И. 11, 2067
- Ш и к и на Н. И., Ш и к и н В. Б. Нелинейные особенности ВАХ для барьеров с седловыми точками. 4, 749
- Ш и к и на Н. И., Ш и к и н В. Б. Релаксационные явления в полупроводниках с заряженными дислокациями. 11, 2067
- Ш и к то ро в П. Н., см. Гавриленко В. И. 5, 825
- Ш п ла га р д и Г., см. Жуковский П. В. 8, 1473
- Ш и ли н Б. А., см. Дашевский М. Я. 12, 2073
- Ш и н д и ч В. Л., см. Емцев В. В. 2, 374
- Ш и н д и ч В. Л., см. Сирацкий В. М. 10, 1795
- Ш и н ка ре н ко В. К., см. Хируненко Л. И. 6, 1051
- Ш и п и ли н А. В., см. Епифанов М. С. 8, 1359
- Ш и р ко в А. В., см. Валейко М. В. 8, 1437
- Ш и ро ко ва Н. А., см. Каширская Л. М. 8, 1349
- Ш к ло вс к и й Б. И., см. Аладашвили Д. И. 2, 234
- Ш ле н с к и й В. Н., см. Епифанов М. С. 8, 1359
- Ш ло па к Н. В., см. Бумай Ю. А. 12, 2141
- Ш лы г и н П. Н., см. Кирдяшкина Л. А. 3, 560
- Ш ма л ь ц К., см. Емцев В. В. 2, 374

- Шмарцев Юрий Васильевич (к 60-летию со дня рождения). 2, 393
- Шмарцев Ю. В., см. Акимченко И. П. 10, 1857
- Шмарцев Ю. В., см. Быковский В. А. 1, 77
- Шмарцев Ю. В., см. Гермогенов В. П. 6, 1095
- Шмарцев Ю. В., см. Лубышев Д. И. 1, 1862
- Шмидт Н. М., см. Балинас В. 5, 848
- Шмидт Н. М., см. Белоусов М. В. 12, 2177
- Шмидт Н. М., см. Дерингас А. 12, 2167
- Шмугуров В. А., см. Фистуль В. И. 6, 1038
- Шофман В. Г., см. Акимов А. В. 1, 82
- Шпинар Л. И., Ясковец И. И., Клиггер М. И. Двухузельная модель дефектов типа А-центров. 7, 1153
- Шпинар Л. И., см. Клиггер М. И. 10, 1869
- Шпинар Л. И., см. Сирацкий В. М. 10, 1795
- Штанов В. И., см. Брандт Н. Б. 1, 51
- Штаске Р., см. Журавлев К. С. 9, 1645
- Штельмах К. Ф., Захаренков Л. Ф., Романов В. В., Терлецкий И. А., Штельмах С. В. Исследование состава, структуры и магнитных свойств фосфида индия, легированного европием. 8, 1482
- Штельмах К. Ф., Терлецкий И. А., Романов В. В. О состоянии европия в фосфиде индия. 9, 1584
- Штельмах С. В., см. Штельмах К. Ф. 8, 1482
- Шубников М. Л., см. Арушанов Э. К. 7, 1179
- Шубников М. Л., см. Грехов И. В. 12, 2203
- Шульга М. И., см. Джаманбалин К. К. 12, 2089
- Шяткус А., см. Денис В. 4, 720
- Шакин И. А., см. Бумай Ю. А. 12, 2141
- Шамхалова Б. С., см. Сурис Р. А. 9, 1638
- Щедрин А. И., см. Владимиров В. В. 11, 1995
- Эйдензон А. М., см. Бузынин А. Н. 2, 264
- Эмексузян В. М., см. Болотов В. В. 10, 1697
- Энфиаджян Р. Л., см. Аветисян С. К. 4, 766
- Эпиктетова Л. Е., см. Гермогенов В. П. 6, 1095
- Эфрос Ал. Л., см. Гельмонт Б. Л. 1, 198
- Юнович А. Э., см. Болгов С. С. 9, 1677
- Юнович А. Э., см. Олеск С. А. 5, 795
- Юнусов М. С., см. Хакимов З. М. 1, 29
- Юрков С. Н., см. Кирдяшкина Л. А. 3, 560
- Юрчук С. Ю., см. Кольцов Г. И. 5, 782
- Юршенас С., см. Балтрамеюнас Р. 9, 1550
- Юшка Г., см. Голикова О. А. 7, 1190
- Яблоновский Е. И., см. Малотенко В. К. 5, 866
- Яблоновский Е. И., см. Пиппа В. И. 7, 1175
- Якименко И. Ю., см. Белоусов М. В. 12, 2177
- Яковлев В. А., Яковлев С. В. Температурная и концентрационная зависимости положения линии излучения локализованных экситонов твердых полупроводниковых растворов $Zn_xCd_{1-x}S$. 4, 706
- Яковлев С. В., см. Яковлев В. А. 4, 706
- Яковлев Ю. П., см. Андаспаева А. А. 10, 1708
- Яковлев Ю. П., см. Афрайлов М. А. 8, 1397
- Яковлев Ю. П., см. Баранов А. Н. 1, 98
- Яковлев Ю. П., см. Баранов А. Н. 6, 1072
- Яковлев Ю. П., см. Титков А. Н. 6, 1056
- Якушева Н. А., см. Журавлев К. С. 4, 702
- Якушева Н. А., см. Журавлев К. С. 5, 829
- Якушева Н. А., см. Журавлев К. С. 9, 1645
- Яременко И. Е., см. Андреев А. П. 5, 821
- Ярошевич А. С., см. Альперович В. Л. 3, 451
- Ясковец И. И., см. Клиггер М. И. 10, 1869
- Ясковец И. И., см. Сирацкий В. М. 10, 1795
- Ясковец И. И., см. Шпинар Л. И. 7, 1153
- Ясневич И. Н., см. Афрайлов М. А. 8, 1397
- Ясневич И. Н., см. Дмитриев А. П. 12, 2193
- Яфясов А. М., Перепелкин А. Д., Мясоедов Ю. Н., Матвиев М. В. Электрофизические свойства поверхности непрерывных твердых растворов (MnHg). Те. 5, 875
- Яшник В. И., см. Критская Т. В. 6, 1129
- Яшник В. И., см. Маринченко А. В. 6, 1126
- Яшник В. И., см. Помозов Ю. В. 6, 993
- Ящипский Л. В., см. Федосов А. В. 4, 754